(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5808807号

(P5808807)

(45) 発行日 平成27年11月10日(2015.11.10)

- (24) 登録日 平成27年9月18日 (2015.9.18)
- (51) Int.Cl. F I HO 1 J 49/42 (2006.01) HO 1 J 49/42 HO 1 J 49/06 (2006.01) HO 1 J 49/06

講求頂の数	20	(全 41	旦)
	20	(HE) (H)	

(21) 出願番号	特願2013-522063 (P2013-522063)	(73)特許権者	f 510075457
(86) (22) 出願日	平成23年8月3日(2011.8.3)		ディーエイチ テクノロジーズ デベロッ
(65) 公表番号	特表2013-532893 (P2013-532893A)		プメント プライベート リミテッド
(43) 公表日	平成25年8月19日 (2013.8.19)		シンガポール国 739256 シンガポ
(86) 国際出願番号	PCT/CA2011/000889		ール, マーシリング インダストリアル
(87)国際公開番号	W02012/016330		エステート ロード 3 33 ナンバ
(87) 国際公開日	平成24年2月9日 (2012.2.9)		-04 - 06
審査請求日	平成26年7月24日 (2014.7.24)	(74)代理人	100078282
(31) 優先権主張番号	61/370, 492		弁理士 山本 秀策
(32) 優先日	平成22年8月4日(2010.8.4)	(74) 代理人	100113413
(33)優先権主張国	米国(US)		弁理士 森下 夏樹
		(72)発明者	ロボダ, アレクサンダー
			カナダ国 エル4ワイ 5ジー7 オンタ
			リオ, ソーンヒル, ヨークヒル ブー
			ルバード 726
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】放射方向振幅支援トランスファのための線形イオントラップ

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための質量分析計であって、

該質量分析計は、

イオン源と、

第1の軸方向加速領域であって、該第1の軸方向加速領域は、該質量分析計の長手軸に 沿って、該イオン源からのイオンの少なくとも一部分を軸方向に加速する、第1の軸方向 加速領域と、

該イオン源から該イオンを受容するように配設される少なくとも1つの線形イオントラ ップであって、該少なくとも1つの線形イオントラップは、

該イオンを中に受容する入口領域と、

該少なくとも1つの線形イオントラップから外へ放射方向に励起されたイオンをトラ ンスファさせる出口領域と、

少なくとも1つのDC(直流)電極であって、該少なくとも1つのDC電極は、DC ポテンシャル障壁を印加して、励起されていないイオンが該少なくとも1つの線形イオン トラップから流出することを防止する、少なくとも1つのDC電極と、

該入口領域と該出口領域との間の放射方向励起領域であって、該放射方向励起領域は、該少なくとも1つの線形イオントラップに捕捉された該イオンを選択的に放射方向に励 起することにより、該放射方向に励起されたイオンを産生する、放射方向励起領域と、

第2の軸方向加速領域であって、該第2の軸方向加速領域は、RF電場強度の低減に ²⁰

よって産生される擬似ポテンシャルに起因して該放射方向に励起されたイオンを該出口領 域に向かって該長手軸に沿ってさらに加速することにより、放射方向に励起されない該励 起されていないイオンが該少なくとも1つの線形イオントラップの中にとどまっている間 に、該第1の軸方向加速領域および該第2の軸方向加速領域に起因する、該放射方向に励 起されたイオンへの力の複合効果は、該放射方向に励起されたイオンが該DCポテンシャ ル障壁を克服するようにさせる、第2の軸方向加速領域と

を含む、少なくとも1つの線形イオントラップと、

検出デバイスであって、該検出デバイスは、該少なくとも1つの線形イオントラップか ら流出する該放射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を受容し、分析する、検出 デバイスと

を含む、質量分析計。

【請求項2】

前記第1の軸方向加速領域は、

前記イオン源と前記少なくとも1つの線形イオントラップとの間にあることであって、 該第1の軸方向領域の中における加速は、長手方向DCポテンシャルを前記イオンの前記 少なくとも一部分に提供することによって起こる、ことと、

前記出口領域より前の該少なくとも1つの線形イオントラップの中にあることであって 、該第1の軸方向領域の中における加速は、

該第1の軸方向加速領域の中に前記RF電場における差を提供することであって、該 提供することにより、前記放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長手軸方向 ²⁰ 力をそこで生成する、ことと、

該第1の軸方向加速において長手方向DCポテンシャルを提供することと

のうちの少なくとも1つによって起こる、ことと、

前記放射方向励起領域と該出口領域との間にあることであって、該少なくとも1つの線 形イオントラップは、該放射方向励起領域の中の第1組のRF電極と、該第1の加速領域 の中の第2組のRF電極とを含み、該第2組のRF電極は、該放射方向励起領域と該第1 の加速領域との間の該RF電場の変化を引き起こす回路を介して該第1組のRF電極に電 気的に接続されることにより、該RF電場における該差が、該RF電場の変化によって引 き起こされる、ことと、

該放射方向励起領域と端部トラップとの間にあることであって、該第1の軸方向加速領 ³⁰ 域の中において長手方向DCポテンシャルの差を提供することは、

選択的な放射方向励起中に該放射方向加速領域の中において該イオンを捕捉するため に、該第1の軸方向加速領域の中において第1のDCポテンシャルを印加することであっ て、該第1のDCポテンシャルは、該放射方向励起領域の中におけるDCポテンシャルよ りも大きい、ことと、

該第1のDCポテンシャルよりも小さく、かつ該放射方向励起領域の中の該DCポテ ンシャルよりも小さい第2のDCポテンシャルを、該第1の軸方向加速領域の中に印加す ることであって、該印加することにより、該放射方向励起領域の中のイオンが、該第1の 軸方向加速領域を通して加速され、該長手方向DCポテンシャルおよび該擬似ポテンシャ ルに起因する、該放射方向に励起されたイオンへの力の組み合わせが、該放射方向に励起 されたイオンが該DCポテンシャル障壁を克服するようにさせることと

40

10

を含み、該放射方向励起領域は、該放射方向に励起されたイオンを産生する少なくと も1組のRF電極と、減少するDCポテンシャルを提供する少なくとも1組のDC電極と を含み、該第2のDCポテンシャルを印加する前に、該減少するDCポテンシャルは、該 放射方向励起領域の中に印加され、したがって、該放射方向に励起されたイオンに付加的 な加速力を印加する、ことと

のうちの少なくとも1つ<u>に該当する</u>、請求項1に記載の質量分析計。

【請求項3】

前記少なくとも1つのイオントラップは、RF電極を含み、該RF電極の間の放射方向 距離が、前記第1の軸方向加速領域の中において増加することにより、前記RF電場にお 50

(2)

ける前記差を提供することは、該距離の変化に起因して起こり、

該RF電極の間の該距離は、該RF電極の形状の変化に起因し、

該RF電極は、

該第1の軸方向加速領域の中で直径が減少することと、

該第1の軸方向加速領域の中でテーパ状であることと、

該第1の軸方向加速領域の中で階段状であることと

のうちの少なくとも1つに該当する、請求項2に記載の質量分析計。

【請求項4】

前記 R F 電場における前記差を提供することは、前記第1の加速領域の中に R F 勾配を 提供することを含み、

前記第2の軸方向加速領域は、

前記出口領域に隣接することであって、前記少なくとも1つのDC電極は、該出口領域に隣接して位置する、ことと、

該第2の軸方向加速領域が、該第1の加速領域と該出口領域との間に位置することであって、該少なくとも1つのDC電極は、該第1の加速領域と該出口領域との間に位置する、ことと

のうちの少なくとも1つに該当する、請求項2に記載の質量分析計。

【請求項5】

前記放射方向励起領域は、前記放射方向に励起されたイオンを産生する少なくとも1組のRF電極と、前記長手方向DCポテンシャルを提供する少なくとも1組のDC電極とを 20 含み、前記第2の軸方向加速領域は、前記出口領域に隣接し、該少なくとも1つのDC電 極は、該出口領域に隣接して位置し、

該少なくとも1組のDC電極の間の距離は、該DC電極の入口端から該DC電極の出口 端まで増加し、それにより、該長手方向DCポテンシャルを提供し、

該少なくとも1組のDC電極の各々は、該長手方向DCポテンシャルを産生する一連の 対向DC電極を含み、該一連の対向DC電極は、該一連の各連続した電極におけるDCポ テンシャルステップとして、該長手方向DCポテンシャルを前記イオンに印加するように 独立して制御される、請求項2に記載の質量分析計。

【請求項6】

前記放射方向励起領域は、

前記第1の軸方向加速領域であって、前記放射方向に励起されたイオンへの長手軸方向 力は、該放射方向励起領域の中の分割RF電極に起因し、該分割RF電極は各々、それぞ れの印加されたDC電圧を有し、該DC電圧は、該放射方向加速領域の入口端から該放射 方向加速領域の出口端まで減少する、第1の軸方向加速領域と、

該第1の軸方向加速領域であって、該放射方向に励起されたイオンへの長手軸方向力は 、該放射方向励起領域の中のRF電極上の抵抗被覆に起因する、第1の軸方向加速領域と のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の質量分析計。

【請求項7】

前記少なくとも1つの線形イオントラップは、

AC(交流)電場と、

RF電圧を選択されたイオンに対する不安定閾値に近づけることと、

該RF電圧を励起の持続時間にわたって該不安定閾値に、またはそれ以上に増加させ、 次いで、該RF電圧を下げることと

のうちの少なくとも1つを介して前記放射方向に励起されたイオンを産生することに使 用可能にされる、請求項1に記載の質量分析計。

【請求項8】

前記第2の軸方向加速領域は、前記出口領域に隣接することと、該出口領域の前にある こととのうちの少なくとも1つに該当する、請求項1に記載の質量分析計。

【請求項9】

質量分析計における放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための方法であって ⁵⁰

30

10

該方法は、

イオン源の中においてイオンを産生することと、

第1の軸方向加速領域の中において、該質量分析計の長手軸に沿って該イオンの少なく とも一部分を軸方向に加速することと、

第2の軸方向加速領域の中において擬似ポテンシャルを、イオントラップの中の放射方 向に励起されたイオンに印加することであって、該擬似ポテンシャルが、RF電場強度の 低減によって産生され、それにより、放射方向に励起されない励起されていないイオンが 、少なくとも1つの線形イオントラップの中にとどまっている間に、該第1の軸方向加速 領域および該第2の軸方向加速領域に起因する、該放射方向に励起されたイオンへの力の 複合効果が、該放射方向に励起されたイオンがDC(直流)ポテンシャル障壁を克服する ようにさせ、該線形イオントラップは、該イオン源から該イオンを受容するように配設さ れ、該少なくとも1つの線形イオントラップは、該イオンを中に受容する入口領域と、放 射方向に励起されたイオンを該少なくとも1つの線形イオントラップから外にトランスフ ァさせる出口領域と、該DCポテンシャル障壁を印加して、該励起されていないイオンが 該少なくとも1つの線形イオントラップから流出することを防止する少なくとも1つのD C電極と、該少なくとも1つの線形イオントラップの中に捕捉された該イオンを選択的に 放射方向に励起することにより、該放射方向に励起されたイオンを産生する、該入口領域 と該出口領域との間の放射方向励起領域とを含む、ことと、

検出デバイスにおいて該放射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を分析するこ ²⁰ とと

を含む、方法。

【請求項10】

前記少なくとも1つの線形イオントラップは、

AC(交流)電場と、

RF電圧を選択されたイオンの不安定閾値に近づけることと、

該RF電圧を励起の持続時間にわたって増加させ、次いで、該RF電圧を下げることと のうちの少なくとも1つを介して前記放射方向に励起されたイオンを産生することに使 用可能にされる、請求項9に記載の方法。

【請求項11】

質量分析計における放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための方法であって

該方法は、

イオンをイオン源からRAATに使用可能な線形イオントラップの中に放出することと

該イオンの少なくとも一部分を放射方向に励起して、該線形イオントラップの中において放射方向に励起されたイオンを産生することと、

該質量分析計の長手軸に沿って、該イオンおよび該放射方向に励起されたイオンのうち の少なくとも1つを加速することであって、該加速することは、該放射方向に励起するス テップの前、および該放射方向に励起するステップの後のうちの少なくとも1つにおいて 起こる、ことと、

R F 電場強度の低減によって産生される擬似ポテンシャルに起因して、該放射方向に励 起されたイオンを該長手軸に沿ってさらに加速することであって、該加速することにより 、放射方向に励起されない該イオンが、該線形イオントラップの中にとどまっている間に 、該加速するステップおよび該さらに加速することに起因する、該放射方向に励起された イオンへの力の組み合わせは、該放射方向に励起されたイオンがDCポテンシャル障壁を 克服し、該線形イオントラップから流出するようにさせることと

を含む、方法。

【請求項12】

前記加速するステップは、前記放射方向に励起するステップの前に起こり、該加速する 50

30

ステップは、前記イオン源と前記線形イオントラップとの間においてさらに起こる、請求 項11に記載の方法。

【請求項13】

前記加速するステップは、

前記出口領域より前の前記線形イオントラップの中にRF電場における差を提供することであって、該提供することにより、前記放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長手軸方向力をその間に生成する、ことと、

前記イオンおよび該放射方向に励起されたイオンのうちの少なくとも1つに長手方向D Cポテンシャルを提供することと

のうちの少なくとも1つによって起こり、

前記RF電場における前記差を提供することは、

前記線形イオントラップの中のRF電極の間の増加する放射方向距離と、

該RF電極の形状の変化と、

該線形イオントラップの少なくとも第1の部分の中の該RF電極の直径の減少と、

該RF電極が該線形イオントラップの少なくとも第2の部分においてテーパ状であることと、

該RF電極が該線形イオントラップの少なくとも第3の部分において階段状であることと、

該線形イオントラップが、第1組のRF電極と、前記出口領域に隣接する少なくとも第 2組のRF電極とを含むことであって、該第2組のRF電極は、該RF電場における該差 ²⁰ を引き起こす回路を介して、該第1組のRF電極に電気的に接続される、ことと

のうちの少なくとも1つによってRF勾配を提供することを含む、請求項11に記載の 方法。

【請求項14】

前記長手方向DCポテンシャルを提供することは、少なくとも1組のDC電極の間の距離を増加させることによって起こり、該少なくとも1組のDC電極は、前記線形イオント ラップの中において長手方向に延在する、請求項13に記載の方法。

【請求項15】

前記長手方向DCポテンシャルを提供することは、前記線形イオントラップの中におい て長手方向に延在する一連の対向DC電極を提供することによって起こり、該一連の対向 DC電極は、該長手方向DCポテンシャルを産生し、該一連の対向DC電極は、該長手方 向DCポテンシャルを該一連の各連続した電極におけるDCポテンシャルステップとして 前記イオンに印加するよう独立して制御される、請求項<u>13</u>に記載の方法。

【請求項16】

前記放射方向励起領域は、前記第1の軸方向加速領域を含み、前記放射方向に励起され たイオンへの長手軸方向力は、該放射方向励起領域の中の分割RF電極に起因し、該分割 RF電極は各々、それぞれの印加されたDC電圧を有し、該DC電圧は、該放射方向加速 領域の入口端から該放射方向加速領域の出口端まで減少する、請求項11に記載の方法。 【請求項17】

前記放射方向励起領域は、前記第1の軸方向加速領域を含み、前記放射方向に励起され 40 たイオンへの長手軸方向力は、該放射方向励起領域の中のRF電極上の抵抗被覆に起因す る、請求項11に記載の方法。

【請求項18】

前記線形イオントラップから前記放射方向に励起されたイオンを抽出することをさらに 含み、該抽出することは、

前記出口領域に隣接して第1のDCポテンシャルを印加することであって、該第1のD Cポテンシャルを印加することにより、選択的な放射方向励起中に該線形イオントラップ の放射方向加速領域の中に該イオンを捕捉し、該第1のDCポテンシャルは、該放射方向 励起領域の中のDCポテンシャルよりも大きい、ことと、

該出口領域に隣接して第2のDCポテンシャルを印加することであって、該第2のDC 50

(5)

ポテンシャルは、該第1のDCポテンシャルよりも小さく、かつ該放射方向励起領域の中 の該DCポテンシャルよりも小さく、その結果、該放射方向励起領域の中のイオンが、該 出口領域へと加速され、前記長手方向DCポテンシャルおよび前記擬似ポテンシャルに起 因する、該放射方向に励起されたイオンへの前記力の組み合わせは、該放射方向に励起さ れたイオンが前記DCポテンシャル障壁を克服するようにさせる、ことと

による、請求項13に記載の方法。

【請求項19】

前記第2のDCポテンシャルを印加する前に、前記放射方向励起領域の中に減少するD Cポテンシャルを印加し、したがって、前記放射方向に励起されたイオンに付加的な加速 力を印加することをさらに含む、請求項18に記載の方法。

【請求項20】

放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための質量分析計であって、

該質量分析計は、

イオン源と、

イオンを該イオン源から受容するように配設される少なくとも1つの線形イオントラッ プであって、該少なくとも1つの線形イオントラップは、

該イオンを中に受容する入口領域と、

放射方向に励起されたイオンを該少なくとも1つの線形イオントラップから外へトラ ンスファさせる出口領域と、

少なくとも1つのDC(直流)電極であって、該少なくとも1つのDC電極は、DC ²⁰ ポテンシャル障壁を印加して<u>、励</u>起されていないイオンが該少なくとも1つの線形イオン トラップから流出することを防止する、少なくとも1つのDC電極と、

該入口領域と該出口領域との間の放射方向励起領域であって、該放射方向励起領域は、 該線形イオントラップに捕捉された該イオンを選択的に放射方向に励起することにより、 AC(交流)電場の印加を介して放射方向に励起されたイオンを産生する、放射方向励起 領域と

を含む、少なくとも1つの線形イオントラップと、

該放射方向励起領域と該少なくとも1つの線形イオントラップの出口との間の軸方向加 速領域であって、該軸方向加速領域は、該軸方向加速領域の中にRF電場における差を提 供することによって、該イオン源からの該イオンの少なくとも一部分を該質量分析計の長 手軸に沿って軸方向に加速して、該放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長 手軸方向力をそこで生成し、該RF電場における該差は、

30

10

該少なくとも1つの線形イオントラップの中のRF電極の間の増加する距離と、 該RF電極の形状の変化と、

該線形イオントラップの少なくとも第1の部分の中の該RF電極の直径の減少と、 該RF電極が該線形イオントラップの少なくとも第2の部分においてテーパ状である ことと、

該RF電極が該線形イオントラップの少なくとも第3の部分において階段状であることと、

該線形イオントラップが、第1組のRF電極と、該出口領域に隣接する少なくとも第 40 2組のRF電極とを含むことであって、該第2組のRF電極は、該RF電場における該差 を引き起こす回路を介して、該第1組のRF電極に電気的に接続される、ことと

のうちの少なくとも1つからのRF勾配によって提供される、軸方向加速領域と、 該放射方向励起領域と該出口との間の少なくとも1つの電極であって、該少なくとも1 つの電極は、該励起されていないイオンが該出口に到達することを防止するDC(直流) ポテンシャル障壁を提供し、該放射方向に励起されたイオンへの該擬似ポテンシャル長手 軸方向力は、該DCポテンシャル障壁を克服することにより、該放射方向に励起されたイ オンが該DCポテンシャル障壁を克服し、該少なくとも1つのイオントラップから流出す る、少なくとも1つの電極と、

検出デバイスであって、該検出デバイスは、該少なくとも1つのイオントラップから流 50

(7)

出する該放射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を受容し、分析する、検出デバ イスと

を含む、質量分析計。

【技術分野】

[0001]

(分野)

本明細書は、概して、質量分析計に関し、さらに具体的には、放射方向振幅支援トラン スファのための線形イオントラップに関する。

【背景技術】

10

[0002]

(背景)

質量選択的軸方向放出(MSAE)は、イオンを選択し、放射方向励起を印加すること によって軸に沿ってイオンを放出するために、質量分析計の線形イオンガイドにおいて使 用される技法である。イオンは、RF(無線周波数)四重極電場によって放射方向に、お よびイオンガイドの端部に印加される静的DC(直流)ポテンシャルによって軸方向に捕 捉される。軸方向力は、放射方向励起の振幅に依存しているイオンガイドの外縁領域で軸 方向に発展する擬似ポテンシャルにより発生する。振幅が高いときに、放射方向に励起さ れたイオンが放出される。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

[0003]

本明細書の第1の側面は、放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための質量分 析計を提供し、質量分析計は、イオン源と、質量分析計の長手軸に沿って、イオン源から のイオンの少なくとも一部分を軸方向に加速するための第1の軸方向加速領域と、イオン 源からイオンを受容するように配設される、少なくとも1つの線形イオントラップとを備 え、少なくとも1つの線形イオントラップは、その中にイオンを受容するための入口領域 と、少なくとも1つの線形イオントラップから外へ放射方向に励起されたイオンをトラン スファさせるための出口領域と、励起されていないイオンが少なくとも1つの線形イオン トラップから流出することを防止するように、DCポテンシャル障壁を印加するための少 なくとも1つのDC(直流)電極と、少なくとも1つの線形イオントラップに捕捉され、 それにより、放射方向に励起されたイオンを産生する、イオンの選択的放射方向励起のた めの入口領域と出口領域との間の放射方向励起領域と、放射方向に励起されない、励起さ れていないイオンが、少なくとも1つの線形イオントラップの中にとどまっている間に、 第1の軸方向加速領域および第2の軸方向加速領域による、放射方向に励起されたイオン への力の複合効果が、放射方向に励起されたイオンにDCポテンシャル障壁を克服させる ように、RF電場強度の低減によって産生される擬似ポテンシャルにより、出口領域に向 かって長手軸に沿って、放射方向に励起されたイオンをさらに加速するための第2の軸方 向加速領域とを備える。質量分析計はさらに、少なくとも1つの線形イオントラップから 流出する、放射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を受容し、分析するための検 出デバイスを備える。

[0004]

第1の軸方向加速領域は、イオン源と少なくとも1つの線形イオントラップとの間に位置することができ、第1の軸方向領域の中の加速は、長手方向DCポテンシャルをイオンの前記少なくとも一部分に提供することによって起こる。

【 0 0 0 5 】

第1の軸方向加速領域は、出口領域より前の少なくとも1つの線形イオントラップの中 に位置し、第1の軸方向領域の中の加速は、放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテン シャル長手軸方向力をそこで生成するように、第1の軸方向加速領域の中でRF電場にお ける差を提供するステップと、第1の軸方向加速において長手方向DCポテンシャルを提 20

30

供するステップとのうちの少なくとも1つによって起こることができる。 R F 電場におけ る差を提供するステップは、第1の加速領域の中で R F 勾配を提供するステップを含むこ とができる。少なくとも1つのイオントラップは、 R F 電極を備え、 R F 電極の間の放射 距離は、 R F 電場における差を提供するステップが、距離の変化により起こるように、第 1 の軸方向加速領域の中で増加する。 R F 電極の間の距離は、 R F 電極の形状の変化に起 因し得る。 R F 電極は、第1の軸方向加速領域の中で直径が減少している、第1の軸方向 加速領域の中でテーパ状である、および第1の軸方向加速領域の中で階段状であるのうち の少なくとも1つである。

[0006]

第1の加速領域は、放射方向励起領域と出口領域との間にあり得て、少なくとも1つの ¹⁰ 線形イオントラップは、放射方向励起領域の中の第1組のRF電極と、第1の加速領域の 中の第2組の電極とを備えることができ、第2組のRF電極は、RF電場における差が、 放射方向励起領域と第1の加速領域との間のRF電場の変化によって引き起こされるよう に、変化を引き起こす回路を介して、第1組のRF電極に電気的に接続される。言い換え れば、放射方向に励起されたイオンの軸方向加速は、RF電場の変化に起因する擬似ポテ ンシャルカに起因している。

[0007]

第2の軸方向加速領域は、出口領域に隣接することができ、少なくとも1つのDC電極は、出口領域に隣接して位置することができる。

【 0 0 0 8 】

第2の軸方向加速領域は、第1の加速と出口領域との間に位置することができ、少なくとも1つのDC電極は、第1の加速と出口領域との間に位置することができる。

[0009]

放射方向励起領域は、放射方向に励起されたイオンを産生するための少なくとも1組の RF電極と、長手方向DCポテンシャルを提供するための少なくとも1組のDC電極とを 備えることができる。第2の軸方向加速領域は、出口領域に隣接することができ、少なく とも1つのDC電極もまた、出口領域に隣接して位置することができる。少なくとも1組 のDC電極の間の距離は、DC電極の入口端からDC電極の出口端まで増加し、それによ り、長手方向DCポテンシャルを提供することができる。少なくとも1組のDC電極のう ちのそれぞれは、長手方向DCポテンシャルを産生するための一連の対向DC電極を備え ることができ、一連の対向DC電極は、一連の各連続電極におけるDCポテンシャルステ ップとして、長手方向DCポテンシャルをイオンに印加するように独立して制御される。 【0010】

放射方向励起領域は、第1の軸方向加速領域を備えることができ、放射方向に励起され たイオンへの長手軸方向力は、放射方向励起領域の中の分割RF電極に起因し得て、分割 RF電極は、各々、放射方向加速領域の入口端から放射方向加速領域の出口端まで減少す るそれぞれのDC電圧が印加されている。

[0011]

放射方向励起領域は、第1の軸方向加速領域を備えることができ、放射方向に励起され たイオンへの長手軸方向力は、放射方向励起領域の中のRF電極上の抵抗被覆に起因して ⁴⁰ いる。

【0012】

第1の軸方向加速領域は、放射方向励起領域と端部トラップとの間にあり得て、第1の 軸方向加速領域の中で長手方向DCポテンシャルの差を提供するステップは、選択的放射 方向励起中に放射方向加速領域の中でイオンを捕捉するために、第1の軸方向加速領域の 中で第1のDCポテンシャルを印加するステップであって、第1のDCポテンシャルは、 放射方向励起領域の中のDCポテンシャルよりも大きい、ステップと、放射方向励起領域 の中のイオンが、第1の軸方向加速領域を通して加速され、長手方向DCポテンシャルお よび擬似ポテンシャルによる、放射方向に励起されたイオンへの力の組み合わせが、放射 方向に励起されたイオンにDCポテンシャル障壁を克服させるように、第1のDCポテン

シャルよりも小さく、かつ放射方向励起領域の中のDCポテンシャルよりも小さい第2の DCポテンシャルを、第1の軸方向加速領域の中で印加するステップとを含む。放射方向 励起領域は、放射方向に励起されたイオンを産生するための少なくとも1組のRF電極と 、減少するDCポテンシャルを提供するための少なくとも1組のDC電極とを備えること ができ、第2のDCポテンシャルを印加する前に、減少DCポテンシャルは、放射方向励 起領域の中で印加され、したがって、放射方向に励起されたイオンに付加的な加速力を印 加する。

[0013]

少なくとも1つの線形イオントラップは、AC(交流)電場と、RF電圧を選択された イオンの不安定閾値に近づけるステップと、励起の持続時間にわたって不安定閾値に、ま たはそれ以上にRF電圧を増加させ、次いで、RF電圧を下げるステップと、のうちの少 なくとも1つを介して、放射方向に励起されたイオンを産生することが可能となり得る。 【0014】

第2の軸方向加速領域は、出口領域に隣接する、および出口領域の前にある、のうちの 少なくとも1つとなり得る。

【0015】

本明細書の第2の側面は、質量分析計における放射方向振幅支援トランスファ(RAA T)のための方法を提供し、方法は、イオン源の中でイオンを産生するステップと、第1 の軸方向加速領域の中で、質量分析計の長手軸に沿ってイオンの少なくとも一部分を長手 方向に加速するステップと、第2の軸方向加速領域の中の擬似ポテンシャルを、イオント ラップの中の放射方向に励起されたイオンに印加するステップとを含み、放射方向に励起 されない、励起されていないイオンが、少なくとも1つの線形イオントラップの中にとど まっている間に、第1の軸方向加速領域および第2の軸方向加速領域による、放射方向に 励起されたイオンへの力の複合効果が、放射方向に励起されたイオンにDC(直流)ポテ ンシャル障壁を克服させるように、擬似ポテンシャルは、RF電場強度の低減によって産 生され、線形イオントラップは、イオン源から前記イオンを受容するように配設され、少 なくとも1つの線形イオントラップは、その中にイオンを受容するための入口領域と、少 なくとも1つの線形イオントラップから外へ放射方向に励起されたイオンをトランスファ させるための出口領域と、励起されていないイオンが少なくとも1つの線形イオントラッ プから流出することを防止するように、DCポテンシャル障壁を印加するための少なくと も1つのDC電極と、少なくとも1つの線形イオントラップに捕捉され、それにより、放 射方向に励起されたイオンを産生する、イオンの選択的放射方向励起のための入口領域と 出口領域との間の放射方向励起領域とを備える。方法はさらに、検出デバイスにおいて放 射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を分析するステップを含む。

【0016】

少なくとも1つの線形イオントラップは、AC(交流)電場と、RF電圧を選択された イオンの不安定閾値に近づけるステップと、励起の持続時間にわたってRF電圧を増加さ せ、次いで、RF電圧を下げるステップとのうちの少なくとも1つを介して、放射方向に 励起されたイオンを産生することが可能となり得る。

【0017】

本明細書の第3の側面は、質量分析計における放射方向振幅支援トランスファ(RAA T)のための方法を提供し、方法は、イオン源からのイオンを、RAATに使用可能な線 形イオントラップの中へ放出するステップと、線形イオントラップの中で放射方向に励起 されたイオンを産生するように、イオンの少なくとも一部分を放射方向に励起するステッ プと、質量分析計の長手軸に沿って、イオンおよび放射方向に励起されたイオンのうちの 少なくとも1つを加速するステップであって、加速するステップは、放射方向に励起する ステップの前、および放射方向に励起するステップの後のうちの少なくとも1つで起こる 、ステップと、放射方向に励起されないイオンが、線形イオントラップの中にとどまって いる間に、加速するステップおよびさらに加速するステップによる、放射方向に励起され たイオンへの力の組み合わせが、放射方向に励起されたイオンにDCポテンシャル障壁を 10

20



克服させ、線形イオントラップから流出させるように、 R F 電場強度の低減によって産生 される擬似ポテンシャルにより、長手軸に沿って放射方向に励起されたイオンをさらに加 速するステップとを含む。

【0018】

加速するステップは、放射方向に励起するステップの前に起こることができる。加速す るステップはさらに、イオン源と線形イオントラップとの間で起こることができる。 【0019】

加速するステップは、放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長手軸方向力 をその間で生成するように、出口領域より前の線形イオントラップの中でRF電場におけ る差を提供するステップと、イオンおよび放射方向に励起されたイオンのうちの少なくと も1つに長手方向DCポテンシャルを提供するステップと、のうちの少なくとも1つによ って起こることができる。RF電場における差を提供するステップは、線形イオントラッ プの中のRF電極の間の増加する放射距離と、RF電極の形状の変化と、線形イオントラ ップの少なくとも第1の部分の中のRF電極の直径の減少と、RF電極が線形イオントラ ップの少なくとも第2の部分の中ですーパ状であることと、RF電極が線形イオントラ ップの少なくとも第3の部分の中で階段状であることと、線形イオントラップが、第1組の RF電極と、出口領域に隣接する少なくとも第2組のRF電極とを備え、第2組のRF電 極は、RF電場における差を引き起こす回路を介して、第1組のRF電極に電気的に接続 されることと、のうちの少なくとも1つによって、RF勾配を提供するステップを含むこ とができる。

[0020]

長手方向DCポテンシャルを提供するステップは、線形イオントラップの中で長手方向 に延在する、少なくとも1組のDC電極の間の距離を増加させることによって起こること ができる。

【0021】

長手方向 D C ポテンシャルを提供するステップは、線形イオントラップの中で長手方向 に延在する、一連の対向 D C 電極を提供することによって起こることができ、一連の対向 D C 電極は、長手方向 D C ポテンシャルを産生するためのものであり、一連の対向 D C 電 極は、一連の中の各連続電極における D C ポテンシャルステップとして、長手方向 D C ポ テンシャルをイオンに印加するように独立して制御される。

【0022】

放射方向励起領域は、第1の軸方向加速領域を備えることができ、放射方向に励起され たイオンへの長手軸方向力は、放射方向励起領域の中の分割RF電極に起因し得て、分割 RF電極は、各々、放射方向加速領域の入口端から放射方向加速領域の出口端まで減少す るそれぞれのDC電圧が印加されている。

【0023】

放射方向励起領域は、前記第1の軸方向加速領域を備えることができ、放射方向に励起 されたイオンへの長手軸方向力は、放射方向加速領域の中のRF電極上の抵抗被覆に起因 する。

【0024】

方法はさらに、選択的放射方向励起中に線形イオントラップの放射方向加速領域の中で イオンを捕捉するために、出口領域に隣接して第1のDCポテンシャルを印加するステッ プであって、第1のDCポテンシャルは、放射方向励起領域の中のDCポテンシャルより も大きい、ステップと、放射方向励起領域の中のイオンが、出口領域へ加速され、長手方 向DCポテンシャルおよび擬似ポテンシャルによる、放射方向に励起されたイオンへの力 の組み合わせが、放射方向に励起されたイオンにDCポテンシャル障壁を克服させるよう に、出口領域に隣接して第2のDCポテンシャルを印加するステップであって、第2のD Cポテンシャルは、第1のDCポテンシャルよりも小さく、かつ放射方向励起の中のDC ポテンシャルよりも小さい、ステップとによって、線形イオントラップから放射方向に励 起されたイオンを抽出するステップをさらに含むことができる。方法はさらに、第2のD 10



Cポテンシャルを印加する前に、放射方向励起領域の中のDCポテンシャルを減少させ、 したがって、放射方向に励起されたイオンに付加的な加速力を印加するステップを含むこ とができる。

【0025】

本明細書の第4の側面は、放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための質量分 析計を提供し、質量分析計は、イオン源と、イオン源からイオンを受容するように配設さ れる少なくとも1つの線形イオントラップとを備え、少なくとも1つの線形イオントラッ プは、その中にイオンを受容するための入口領域と、少なくとも1つの線形イオントラッ プから外へ放射方向に励起されたイオンをトランスファさせるための出口領域と、励起さ れていないイオンが少なくとも1つの線形イオントラップから流出することを防止するよ うに、DCポテンシャル障壁を印加するための少なくとも1つのDC(直流)電極と、線 形イオントラップに捕捉され、それにより、AC(交流)電場の印加を介して放射方向に 励起されたイオンを産生する、イオンの選択的放射方向励起のための入口領域と出口領域 との間の放射方向励起領域と、放射方向励起領域と少なくとも1つの線形イオントラップ の出口との間の軸方向加速領域であって、放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシ ャル長手軸方向力をそこで生成するように、軸方向加速領域の中にRF電場における差を 提供することによって、質量分析計の長手軸に沿ってイオン源からのイオンの少なくとも 一部分を軸方向に加速するための軸方向加速領域とを備え、RF電場における差は、少な くとも1つの線形イオントラップの中のRF電極の間の増加する距離と、RF電極の形状 の変化と、線形イオントラップの少なくとも第1の部分の中のRF電極の直径の減少と、 R F 電極が線形イオントラップの少なくとも第2の部分の中においてテーパ状であること と、RF電極が線形イオントラップの少なくとも第3の部分の中において階段状であるこ とと、線形イオントラップが、第1組のRF電極と、出口領域に隣接する少なくとも第2 組のRF電極とを備え、第2組のRF電極は、RF電場における差を引き起こす回路を介 して、第1組のRF電極に電気的に接続されることと、のうちの少なくとも1つからのR F勾配によって提供される。少なくとも1つの線形イオントラップは、励起されていない イオンが前記出口に到達することを防止するようにDC(直流)ポテンシャル障壁を提供 するための、放射方向励起領域と出口との間の少なくとも1つの電極をさらに備え、放射 方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長手軸方向力は、放射方向に励起されたイ オンがDCポテンシャル障壁を克服し、少なくとも1つのイオントラップから流出するよ うに、DCポテンシャル障壁を克服するためのものである。質量分析計は、少なくとも1 つのイオントラップから流出する、放射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を受 容し、分析するための検出デバイスをさらに備える。

【0026】

質量選択的軸方向放出(MSAE)は、質量分析計の線形イオンガイドの中でイオンを 選択し、放出する方法である。一連の着目イオンは、線形イオンガイドに捕捉され、次い で、イオンガイドの出力端を通して質量選択的に放出される。着目イオンは、電圧がイオ ンガイドの出力端付近に位置するDC障壁電極に供給されている間に、最初に励起される 。電圧は、励起されたイオンが開口を介して流出することを可能にしながら、励起されて いないイオンが障壁を横断することを防止するように設定される。励起されたイオンは、 イオンガイドの端部に存在するフリンジ電場によって及ぼされる付加的な軸方向力により 、障壁を横断し、開口を通って流出することができる。軸方向力の大きさは、放射方向励 起の振幅に依存している。

【0027】

高い放射方向振幅(および高い放射エネルギー)を有するイオンが、流出するイオンの 比較的大きい円錐角により、開口において失われ得るため、放出の効率が損なわれ得る。 加えて、たとえイオンが開口をうまく通り抜けても、隣接イオンガイドが高い放射方向振 幅を伴うイオンを含有できないことにより、または軸から遠く離れた高いフリンジ電場に 暴露されたときに高い軸方向エネルギーを獲得するイオンの広範な断片化により、依然と してイオンが失われ得る。

20

10

30

本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。

(項目1)

放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための質量分析計であって、

該質量分析計は、

イオン源と、

第1の軸方向加速領域であって、該第1の軸方向加速領域は、該質量分析計の長手軸に 沿って、該イオン源からのイオンの少なくとも一部分を軸方向に加速する、第1の軸方向 加速領域と、

該イオン源から該イオンを受容するように配設される少なくとも1つの線形イオントラ ップであって、該少なくとも1つの線形イオントラップは、

該イオンを中に受容する入口領域と、

該少なくとも1つの線形イオントラップから外へ放射方向に励起されたイオンをトラ ンスファさせる出口領域と、

少なくとも1つのDC(直流)電極であって、該少なくとも1つのDC電極は、DC ポテンシャル障壁を印加して、励起されていないイオンが該少なくとも1つの線形イオン トラップから流出することを防止する、少なくとも1つのDC電極と、

該入口領域と該出口領域との間の放射方向励起領域であって、該放射方向励起領域は 、該少なくとも1つの線形イオントラップに捕捉された該イオンを選択的に放射方向に励 起して、該放射方向に励起されたイオンを産生する、放射方向励起領域と、

20 第2の軸方向加速領域であって、該第2の軸方向加速領域は、RF電場強度の低減に よって産生される擬似ポテンシャルに起因して該放射方向に励起されたイオンを該出口領 域に向かって該長手軸に沿ってさらに加速することにより、放射方向に励起されない該励 起されていないイオンが該少なくとも1つの線形イオントラップの中にとどまっている間 に、該第1の軸方向加速領域および該第2の軸方向加速領域に起因する、該放射方向に励 起されたイオンへの力の複合効果は、該放射方向に励起されたイオンが該DCポテンシャ ル障壁を克服するようにさせる、第2の軸方向加速領域と

を含む、少なくとも1つの線形イオントラップと、

検出デバイスであって、該検出デ<u>バイスは、該少なくとも1つの線形イオントラップか</u> ら流出する該放射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を受容し、分析する、検出 デバイスと

を含む、質量分析計。

(項目2)

前記第1の軸方向加速領域は、前記イオン源と前記少なくとも1つの線形イオントラッ プとの間に位置し、該第1の軸方向領域の中における加速は、長手方向DCポテンシャル を前記イオンの前記少なくとも一部分に提供することによって起こる、項目1に記載の質 量分析計。

(項目3)

前記第1の軸方向加速領域は、前記出口領域より前の、前記少なくとも1つの線形イオ ントラップの中に位置し、該第1の軸方向領域の中における加速は、

該第1の軸方向加速領域の中に前記RF電場における差を提供することであって、該 提供することにより、前記放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長手軸方向 力をそこで生成する、ことと、

該第1の軸方向加速において長手方向DCポテンシャルを提供することと のうちの少なくとも1つによって起こる、項目1に記載の質量分析計。

(項目4)

前記RF電場における前記差を前記提供することは、前記第1の加速領域の中にRF勾 配を提供することを含む、項目3に記載の質量分析計。

(項目5)

前記少なくとも1つのイオントラップは、RF電極を含み、該RF電極の間の放射方向 距離が、前記第1の軸方向加速領域の中において増加することにより、前記RF電場にお

10

30

40

50

<u>ける前記差を前記提供することは、該距離の変化に起因して起こる、項目4に記載の質量</u> 分析計。

(項目6)

<u>前記RF電極の間の前記距離は、該RF電極の形状の変化に起因する、項目5に記載の</u> 質量分析計。

(項目7)

前記RF電極は、

前記第1の軸方向加速領域の中で直径が減少することと、

該第1の軸方向加速領域の中でテーパ状であることと、

該第1の軸方向加速領域の中で階段状であることと

のうちの少なくとも1つに該当する、項目5に記載の質量分析計。

(項目8)

前記第1の加速領域は、前記放射方向励起領域と前記出口領域との間にあり、前記少な くとも1つの線形イオントラップは、該放射方向励起領域の中の第1組のRF電極と、該 第1の加速領域の中の第2組の電極とを含み、該第2組のRF電極は、該放射方向励起領 域と該第1の加速領域との間の前記RF電場の変化を引き起こす回路を介して該第1組の RF電極に電気的に接続されることにより、該RF電場における前記差が、該RF電場の 変化によって引き起こされる、項目3に記載の質量分析計。

(項目9)

<u>前記第2の軸方向加速領域は、前記出口領域に隣接し、前記少なくとも1つのDC電極</u>20 は、該出口領域に隣接して位置する、項目4に記載の質量分析計。

(項目10)

前記第2の軸方向加速領域は、前記第1の加速領域と前記出口領域との間に位置し、前 記少なくとも1つのDC電極は、該第1の加速領域と該出口領域との間に位置する、項目 4に記載の質量分析計。

(項目11)

前記放射方向励起領域は、前記放射方向に励起されたイオンを産生する少なくとも1組 のRF電極と、前記長手方向DCポテンシャルを提供する少なくとも1組のDC電極とを 含み、前記第2の軸方向加速領域は、前記出口領域に隣接し、該少なくとも1つのDC電 極は、該出口領域に隣接して位置する、項目3に記載の質量分析計。

(項目12)

前記少なくとも1組のDC電極の間の距離は、該DC電極の入口端から該DC電極の出 口端まで増加し、それにより、前記長手方向DCポテンシャルを提供する、項目11に記 載の質量分析計。

(項目13)

前記少なくとも1組のDC電極の各々は、前記長手方向DCポテンシャルを産生する一 連の対向DC電極を含み、該一連の対向DC電極は、該一連の各連続した電極におけるD Cポテンシャルステップとして、該長手方向DCポテンシャルを前記イオンに印加するよ うに独立して制御される、項目11に記載の質量分析計。

(項目14)

前記放射方向励起領域は、前記第1の軸方向加速領域を含み、前記放射方向に励起され るイオンへの長手軸方向力は、該放射方向励起領域の中の分割RF電極に起因し、該分割 RF電極は各々、それぞれのDC電圧が印加されており、該DC電圧は、該放射方向加速 領域の入口端から該放射方向加速領域の出口端まで減少する、項目1に記載の質量分析計

(項目15)

前記放射方向励起領域は、前記第1の軸方向加速領域を含み、前記放射方向に励起され たイオンへの長手軸方向力は、該放射方向励起領域の中のRF電極上の抵抗被覆に起因す る、項目1に記載の質量分析計。

(項目16)

30

40

前記第1の軸方向加速領域は、前記放射方向励起領域と前記端部トラップとの間にあり 、該第1の軸方向加速領域の中において前記長手方向DCポテンシャルの差を前記提供す ることは、

選択的な放射方向励起中に該放射方向加速領域の中において前記イオンを捕捉するため に、該第1の軸方向加速領域の中において第1のDCポテンシャルを印加することであっ て、該第1のDCポテンシャルは、該放射方向励起領域の中におけるDCポテンシャルよ りも大きい、ことと、

該第1のDCポテンシャルよりも小さく、かつ該放射方向励起領域の中の該DCポテン シャルよりも小さい第2のDCポテンシャルを、該第1の軸方向加速領域の中に印加する ことであって、該印加することにより、該放射方向励起領域の中のイオンが、該第1の軸 方向加速領域を通して加速され、該長手方向DCポテンシャルおよび前記擬似ポテンシャ ルに起因する、前記放射方向に励起されるイオンへの力の組み合わせが、該放射方向に励 起されたイオンが前記DCポテンシャル障壁を克服するようにさせることと

10

を含む、項目2に記載の質量分析計。

(項目17)

前記放射方向励起領域は、前記放射方向に励起されたイオンを産生する少なくとも1組 のRF電極と、減少するDCポテンシャルを提供する少なくとも1組のDC電極とを含み 、前記第2のDCポテンシャルを印加する前に、該減少するDCポテンシャルは、該放射 方向励起領域の中に印加され、したがって、該放射方向に励起されたイオンに付加的な加 速力を印加する、項目16に記載の質量分析計。

(項目18)

前記少なくとも1つの線形イオントラップは、

AC(交流)電場と、

RF電圧を選択されたイオンに対する不安定閾値に近づけることと、

<u>該RF電圧を励起の持続時間にわたって該不安定閾値に、またはそれ以上に増加させ、</u>次いで、該RF電圧を下げることと、

<u>のうちの少なくとも1つを介して前記放射方向に励起されたイオンを産生することに使</u> 用可能にされる、項目1に記載の質量分析計。

(項目19)

<u>前記第2の軸方向加速領域は、前記出口領域に隣接することと、該出口領域の前にある</u>30 こととのうちの少なくとも1つに該当する、項目1に記載の質量分析計。

(項目20)

<u>質量分析計における放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための方法であって</u>

該方法は、

イオン源の中においてイオンを産生することと、

<u>第1の軸方向加速領域の中において、該質量分析計の長手軸に沿って該イオンの少なく</u> とも一部分を軸方向に加速することと、

第2の軸方向加速領域の中において擬似ポテンシャルを、イオントラップの中の放射方 向に励起されたイオンに印加することであって、該擬似ポテンシャルが、RF電場強度の 低減によって産生され、それにより、放射方向に励起されない励起されていないイオンが 、少なくとも1つの線形イオントラップの中にとどまっている間に、該第1の軸方向加速 領域および該第2の軸方向加速領域に起因する、該放射方向に励起されたイオンへの力の 複合効果が、該放射方向に励起されたイオンがDC(直流)ポテンシャル障壁を克服する ようにさせ、該線形イオントラップは、該イオン源から該イオンを受容するように配設さ れ、該少なくとも1つの線形イオントラップは、該イオンを中に受容する入口領域と、放 射方向に励起されたイオンを該少なくとも1つの線形イオントラップから外にトランスフ ァさせる出口領域と、該DCポテンシャル障壁を印加して、該励起されていないイオンが 該少なくとも1つの線形イオントラップから流出することを防止する少なくとも1つのD C電極と、該少なくとも1つの線形イオントラップの中に捕捉された該イオンを選択的に

20

(15)

__検出デバイスにおいて該放射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を分析することと

を含む、方法。

(項目21)

前記少なくとも1つの線形イオントラップは、

AC(交流)電場と、

RF電圧を選択されたイオンの不安定閾値に近づけることと、

<u>該RF電圧を励起の持続時間にわたって増加させ、次いで、該RF電圧を下げることと</u> 10 のうちの少なくとも1つを介して前記放射方向に励起されたイオンを産生することに使 用可能にされる、項目20に記載の方法。

(項目22)

____ 質量分析計における放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための方法であって

該方法は、

<u>イオンをイオン源からRAATに使用可能な線形イオントラップの中に放出することと</u>、

<u>該イオンの少なくとも一部分を放射方向に励起して、該線形イオントラップの中におい</u> て放射方向に励起されたイオンを産生することと、

20

該質量分析計の長手軸に沿って、該イオンおよび該放射方向に励起されたイオンのうち の少なくとも1つを加速することであって、該加速することは、該放射方向に励起するこ との前、および該放射方向に励起することの後のうちの少なくとも1つにおいて起こる、 ことと、

RF電場強度の低減によって産生される擬似ポテンシャルに起因して、該放射方向に励起されたイオンを該長手軸に沿ってさらに加速することであって、該加速することにより、放射方向に励起されない該イオンが、該線形イオントラップの中にとどまっている間に、該加速することおよびさらに加速すること起因する、該放射方向に励起されたイオンへの力の組み合わせは、該放射方向に励起されたイオンがDCポテンシャル障壁を克服し、該線形イオントラップから流出するようにさせることと

30

<u>を含む、方法。</u> (項目23)

前記加速することは、前記放射方向に励起することの前に起こり、該加速することは、 前記イオン源と前記線形イオントラップとの間においてさらに起こる、項目22に記載の

<u>方法。</u>

(項目24)

前記加速することは、

前記出口領域より前の前記線形イオントラップの中にRF電場における差を提供することであって、該提供することにより、前記放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長手軸方向力をその間に生成する、ことと、

40

<u>前記イオンおよび該放射方向に励起されたイオンのうちの少なくとも1つに長手方向D</u> Cポテンシャルを提供することと

のうちの少なくとも1つによって起こる、項目22に記載の方法。

(項目25)

前記RF電場における前記差を前記提供することは、

前記線形イオントラップの中のRF電極の間の増加する放射方向距離と、

該RF電極の形状の変化と、

該線形イオントラップの少なくとも第1の部分の中の該RF電極の直径の減少と、

___該 R F 電極が該線形イオントラップの少なくとも第 2 の部分においてテーパ状であるこ とと、_____

<u>該RF電極が該線形イオントラップの少なくとも第3の部分において階段状であること</u>と、

該線形イオントラップが、第1組のRF電極と、前記出口領域に隣接する少なくとも第 2組のRF電極とを含むことであって、該第2組のRF電極は、該RF電場における該差 を引き起こす回路を介して、該第1組のRF電極に電気的に接続される、ことと

<u>のうちの少なくとも1つによってRF勾配を提供することを含む、項目24に記載の方</u>法。

(項目26)

前記長手方向DCポテンシャルを前記提供することは、少なくとも1組のDC電極の間 の距離を増加させることによって起こり、該少なくとも1組のDC電極は、前記線形イオ ¹⁰ ントラップの中において長手方向に延在する、項目22に記載の方法。

(項目27)

前記長手方向DCポテンシャルを前記提供することは、前記線形イオントラップの中に おいて長手方向に延在する一連の対向DC電極を提供することによって起こり、該一連の 対向DC電極は、該長手方向DCポテンシャルを産生し、該一連の対向DC電極は、該長 手方向DCポテンシャルを該一連の各連続した電極におけるDCポテンシャルステップと して前記イオンに印加するよう独立して制御される、項目22に記載の方法。

(項目28)

前記放射方向励起領域は、前記第1の軸方向加速領域を含み、前記放射方向に励起され たイオンへの長手軸方向力は、該放射方向励起領域の中の分割RF電極に起因し、該分割 RF電極は各々、それぞれのDC電圧が印加されており、該DC電圧は、該放射方向加速 領域の入口端から該放射方向加速領域の出口端まで減少する、項目22に記載の方法。 (項目29)

前記放射方向励起領域は、前記第1の軸方向加速領域を含み、前記放射方向に励起され たイオンへの長手軸方向力は、該放射方向励起領域の中のRF電極上の抵抗被覆に起因す る、項目22に記載の方法。

(項目30)

<u>前記線形イオントラップから前記放射方向に励起されたイオンを抽出することをさらに</u> 含み、該抽出することは、

前記出口領域に隣接して第1のDCポテンシャルを印加することであって、該第1のD Cポテンシャルを印加することにより、選択的な放射方向励起中に該線形イオントラップ の放射方向加速領域の中に該イオンを捕捉し、該第1のDCポテンシャルは、該放射方向 励起領域の中のDCポテンシャルよりも大きい、ことと、

該出口領域に隣接して第2のDCポテンシャルを印加することであって、該第2のDC ポテンシャルは、該第1のDCポテンシャルよりも小さく、かつ該放射方向励起領域の中 の該DCポテンシャルよりも小さく、その結果、該放射方向励起領域の中のイオンが、該 出口領域へと加速され、前記長手方向DCポテンシャルおよび前記擬似ポテンシャルに起 因する、該放射方向に励起されたイオンへの前記力の組み合わせは、該放射方向に励起さ れたイオンが前記DCポテンシャル障壁を克服するようにさせる、ことと

による、項目22に記載の方法。

(項目31)

前記第2のDCポテンシャルを印加する前に、前記放射方向励起領域の中に減少するD Cポテンシャルを印加し、したがって、前記放射方向に励起されたイオンに付加的な加速 力を印加することをさらに含む、項目28に記載の方法。

(項目32)

放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための質量分析計であって、

該質量分析計は、

イオン源と、

<u>イオンを該イオン源から受容するように配設される少なくとも1つの線形イオントラッ</u> プであって、該少なくとも1つの線形イオントラップは、

該イオンを中に受容する入口領域と、

放射方向に励起されたイオンを該少なくとも1つの線形イオントラップから外へトラ ンスファさせる出口領域と、

少なくとも1つのDC(直流)電極であって、該少なくとも1つのDC電極は、DC ポテンシャル障壁を印加して、該励起されていないイオンが該少なくとも1つの線形イオ ントラップから流出することを防止する、少なくとも1つのDC電極と、

該入口領域と該出口領域との間の放射方向励起領域であって、該放射方向励起領域は、 該線形イオントラップに捕捉された該イオンを選択的に放射方向に励起することにより、 AC(交流)電場の印加を介して放射方向に励起されたイオンを産生する、放射方向励起 領域と

を含む、少なくとも1つの線形イオントラップと、

該放射方向励起領域と該少なくとも1つの線形イオントラップの出口との間の軸方向加 速領域であって、該軸方向加速領域は、該軸方向加速領域の中にRF電場における差を提 供することによって、該イオン源からの該イオンの少なくとも一部分を該質量分析計の長 手軸に沿って軸方向に加速して、該放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長 手軸方向力をそこで生成し、該RF電場における該差は、

該少なくとも1つの線形イオントラップの中のRF電極の間の増加する距離と、 該RF電極の形状の変化と、

該線形イオントラップの少なくとも第1の部分の中の該RF電極の直径の減少と、

該 R F 電極が該線形イオントラップの少なくとも第2の部分においてテーパ状である ことと、

20

10

該RF電極が該線形イオントラップの少なくとも第3の部分において階段状であるこ とと、

該線形イオントラップが、第1組のRF電極と、該出口領域に隣接する少なくとも第 2組のRF電極とを含むことであって、該第2組のRF電極は、該RF電場における該差 を引き起こす回路を介して、該第1組のRF電極に電気的に接続される、ことと のうちの少なくとも1つからのRF勾配によって提供される、軸方向加速領域と、

該放射方向励起領域と該出口との間の少なくとも1つの電極であって、該少なくとも1 つの電極は、該励起されていないイオンが該出口に到達することを防止するDC(直流) ポテンシャル障壁を提供し、該放射方向に励起されたイオンへの該擬似ポテンシャル長手 軸方向力は、該DCポテンシャル障壁を克服することにより、該放射方向に励起されたイ オンが該DCポテンシャル障壁を克服し、該少なくとも1つのイオントラップから流出す る、少なくとも1つの電極と

30

検出デバイスであって、該検出デバイスは、該少なくとも1つのイオントラップから流 出する該放射方向に励起されたイオンの少なくとも一部分を受容し、分析する、検出デバ イスと

を含む、質量分析計。

[0028]

実装は、以下の図を参照して説明される。

【図面の簡単な説明】

[0029]

【図1】図1は、非限定的実装による、質量分析計のブロック図を図示する。

【図2】図2は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオ ントラップのブロック図を図示する。

【図3】図3は、非限定的実装による、図2の線形イオントラップを含む、質量分析計に おいて印加することができる、DCプロファイルを図示する。

【図4】図4は、非限定的実装による、図2の線形イオントラップのプロトタイプから流 出するイオンのイオン強度を図示する。

【図5A】図5Aは、非限定的実装による、線形イオントラップの長さに沿った座標(×)の関数として描画された、複合DCポテンシャルおよび擬似ポテンシャル分布の基本モ

デルのグラフを図示する。

【図5B】図5Bは、非限定的実装による、線形イオントラップの長さに沿った座標(×)の関数として描画された、複合DCポテンシャルおよび擬似ポテンシャル分布の基本モデルのグラフを図示する。

【図 6 】図 6 は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオ ントラップのブロック図を図示する。

【図7】図7は、非限定的実装による、図6の線形イオントラップを含む、質量分析計に おいて印加することができる、DCプロファイルを図示する。

【図8】図8は、非限定的実装による、図6の線形イオントラップの断面図を図示する。

【図9】図9は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオ 10 ントラップのブロック図を図示する。

【図10】図10は、非限定的実装による、図9の線形イオントラップを含む、質量分析 計において印加することができる、DCプロファイルを図示する。

【図11】図11は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形 イオントラップのブロック図を図示する。

【図12】図12は、非限定的実装による、図11の線形イオントラップを含む、質量分析計において印加することができる、DCプロファイルを図示する。

【図13】図13は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形 イオントラップのブロック図を図示する。

【図14】図14は、非限定的実装による、図13の線形イオントラップを含む、質量分 20 析計において印加することができる、DCプロファイルを図示する。

【図15】図15~17は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオントラップのブロック図を図示する。

【図16】図15~17は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオントラップのブロック図を図示する。

【図17】図15~17は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオントラップのプロック図を図示する。

【図18】図18は、非限定的実装による、質量分析計のブロック図を図示する。

【図19】図19は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための方法のフローチャートを図示する。

【図20】図20は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形 イオントラップのブロック図を図示する。

【図21】図21は、非限定的実装による、一連のDC電極として使用される、PCB(プリント回路基板)の斜視図を図示する。

【図22】図22~24は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオントラップのブロック図を図示する。

【図23】図22~24は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオントラップのブロック図を図示する。

【図24】図22~24は、非限定的実装による、放射方向振幅支援トランスファのための線形イオントラップのブロック図を図示する。

【発明を実施するための形態】

【0030】

図1は、質量分析計100を図示し、質量分析計100は、イオン源120と、イオン ガイド130と、線形イオントラップ140と、衝突セル150(例えば、断片化モジュ ール)と、検出器160とを備え、質量分析計100は、イオン源120から検出器16 0を通してイオンビームを伝送することが可能である。いくつかの実装では、質量分析計 100はさらに、イオン化可能物質をイオン化するようにイオン源120を制御すること 、および質量分析計100のモジュール間のイオンのトランスファを制御することを含む が、それらに限定されない、質量分析計100の動作を制御するためのプロセッサ185 を備えることができる。動作中、イオン化可能物質は、イオン源120に導入される。イ

オン源120は、概して、イオンガイド130(また、O0として識別され、イオンガイ ド130が質量分析に関与しないことを示す)にトランスファさせられる、イオンビーム の形式でイオン190を産生するように、イオン化可能物質をイオン化する。イオン19 0は、以下の図でさらに図示されるように、イオンガイド130から、質量フィルタとし て、または線形イオントラップとして動作することができる四重極140(また、Q1と して識別される)にトランスファさせられる。次いで、濾過されたか、または濾過されて いないイオンが、以下で説明されるように、所望の順序でイオン191を放出するように 制御することができる、a2としても識別される衝突セル150に進入する。いくつかの 実装では、イオン191を衝突セル150の中で断片化されることができる。衝突セル1 50は、四重極、六重極、または八重極等の多重極を含むが、それに限定されない、任意 の好適なRFイオンガイドを含むことができると認識される。次いで、イオン191は、 質量スペクトルの産生のために検出器160にトランスファさせられる。そうする際に、 イオン191は、その中に進入するイオン191の質量スペクトルを産生することが可能 である検出器160に進入する。いくつかの実装では、衝突セル150は、四重極140 と機械的に同様の四重極を備える。他の実施形式では、衝突セルは、イオンの断片化が、 電子捕獲解離、電子トランスファ管理、光解離、表面誘起解離、準安定粒子との相互作用 による解離、または同等物を含むが、それらに限定されない任意の好適な方法によって達 成される、断片化セルに置換することができる。

【0031】

さらに、図示されていないが、質量分析計100は、イオン源120、イオンガイド1 20 30、四重極質量フィルタ140、衝突セル150、および/または検出器160の中に 好適な真空を提供するために、任意の好適な数の真空ポンプを備えることができる。いく つかの実装では、質量分析計100の特定の要素の間に真空差を生成することができ、例 えば、イオン源120が大気圧にあり、イオンガイド130が真空下にあるように、真空 差が、概して、イオン源120とイオンガイド130との間に印加されることが認識され る。また、図示されていないが、質量分析計100は、任意の好適な数のコネクタ、電源 、RF(無線周波数)電源、DC(直流)電源、(例えば、イオン源120および/また は衝突セル150用の)ガス源、および質量分析計100の動作を可能にするための任意 の他の好適な構成要素をさらに備えることができる。

【0032】

ここで、衝突セル150および検出器160と一直線上にある、非限定的実装による、 放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための線形イオントラップ200を図示す る図2に注目する。したがって、図示した実装において、線形イオントラップ200は、 図1の線形イオントラップ140を備える。しかしながら、さらなる実装では、線形イオ ントラップ200は、イオンガイド130を備えることができる。その上さらなる実装で は、線形イオントラップ200は、衝突セル150を備えることができる。 【0033】

線形イオントラップ200は、入口領域201と、放射方向励起領域203と、第1の 軸方向加速領域205と、第2の軸方向加速領域207と、出口領域209とを備える。 【0034】

図2でST1とも標識される入口領域201は、例えば、イオン源120からイオン1 90を受容するための領域、またはイオン源120と線形イオントラップ200との間の 質量分析計100の任意の他の要素を備える。入口領域201は、概して、四重極、六重 極、または八重極等の多重極を含むが、それに限定されない、イオンを線形イオントラッ プ200の中へ受容するための任意の好適な線形イオンガイド211を備える。 【0035】

入口領域211と、207に対する出口領域との間に位置する放射方向励起領域203 は、線形イオントラップ200に捕捉されたイオンの選択的放射方向励起のために使用可 能にされ、それにより、任意の好適なAC(交流)電場を介して放射方向に励起されたイ オンを産生する。代替として、線形イオントラップ200は、RF電圧を選択されたイオ

10

30

40

ンの不安定閾値まで近づけること、または励起の持続時間にわたって不安定閾値付近まで RF電圧を増加させ、次いで、RF電圧を下げることのうちの少なくとも1つによって、 放射方向に励起されたイオンを産生することが可能となり得る。そのようなものとして、 放射方向励起領域203は、概して、四重極、六重極、または八重極等の多重極を含むが 、それに限定されない、その中にイオンを含有し、選択的放射方向励起を行うための任意 の好適な線形イオンガイド213を備える。イオンの選択的放射方向励起は、参照するこ とにより本明細書に組み込まれる、"Mass Selective Axial Io n Ejection from Linear Quadropole Ion Tr ap" by F.A.Londry and James W.Hager,J.Am .Soc.Mass Spectrom.2003,14,1130-1147で説明さ れている。線形イオンガイド213の入口は、図2においてIEと標識されている。 【0036】

(20)

10

線形イオントラップ200はまた、線形イオンガイド215と、出口電極217とも呼ばれる少なくとも1つの出口電極217とを備える。線形イオンガイド215は、線形イオンガイド213と出口電極217との間に位置し、四重極、六重極、および八重極を含むことができるが、それらに限定されない。その中にイオンを含有するための放射方向RF電場を線形イオンガイド215に印加できることが認識される。線形イオンガイド215の出口はまた、図2においてOEと標識されている。

第1の軸方向加速領域205は、以下で説明されるように、長手方向DCポテンシャル 20
によって提供される第1の長手方向加速力F1がイオンに印加される、線形イオンガイド213と線形イオンガイド215との間の遷移領域を備える。しかしながら、一般に、第1の軸方向加速領域205は、質量分析計100の長手軸に沿ってイオン源120からイオン190の少なくとも一部分を軸方向に加速するために使用可能であることが認識される。

[0038]

出口領域207は、イオン190が線形イオントラップ200から流出することを防止 するために、DC(直流)ポテンシャル障壁を印加するために使用可能である。例えば、 DCポテンシャル障壁は、出口電極217に印加することができる。出口電極217は、 それに印加されたDCポテンシャル障壁を克服するイオンが通過することができる開口を 備える。

【 0 0 3 9 】

第2の軸方向加速領域207は、線形イオンガイド215の出口端および/または出口 領域209に隣接する領域を備える。第2の軸方向加速領域207は、出口領域209に 隣接するRF電場強度の低減によって産生される擬似ポテンシャルに起因して、出口領域 209に向かって長手軸に沿って放射方向に励起されたイオン190をさらに加速するた めに使用可能であり、その結果、放射方向に励起されないイオン190が線形イオントラ ップ200の中にとどまっている間、第1の軸方向加速領域205および第2の軸方向加 速領域207に起因する放射方向に励起されたイオン190への力の組み合わせが、放射 方向に励起されたイオン190にDCポテンシャル障壁を克服させる。

【0040】

第2の軸方向加速領域207では、線形イオンガイド215に印加されたRF電場の縁 は、"Mass Selective Axial Ion Ejection fro m Linear Quadropole Ion Trap" by F.A.Lon dry and James W.Hager,J.Am.Soc.Mass Spec trom.2003,14,1130-1147で説明されるように、その中に含有され る放射方向に励起されたイオンがフリンジ擬似ポテンシャルを受けるようにする。フリン ジ擬似ポテンシャルは、放射方向に励起されたイオンが出口領域209に向かう長手方向 力F2を受けるようにする。力F2は、放射方向に励起されたイオン310の励起の振幅 にさらに依存していることが認識される。その上、F2は長手軸上で「0」であるが、長 30

手軸からの放射距離とともに増加することがさらに認識される。 【0041】

従来技術では、少なくとも1つの出口電極に印加されるDCポテンシャル障壁を克服す るために、F2は、概して、イオンの励起の振幅を増加させることによって増加させられ る。しかしながら、これは、放射方向に励起されたイオンの非常に大きい出口角につなが り、次いで、イオンは、出口電極の開口において、または選択的放射方向励起が起こって いる線形イオントラップと衝突セル等の次のモジュールとの間において、失われ得る。言 い換えれば、出口角が非常に大きいので、流出するイオンが質量分析計を通る経路から逸 脱する。

【0042】

線形イオントラップ200におけるこの問題を克服するために、DCポテンシャルを、 線形イオンガイド211、213、215、出口電極217、および衝突セル150の各 々に独立して印加できることがさらに認識される。例えば、図3に注目すると、DCポテ ンシャルの第1のプロファイル300が図示されており、このプロファイルは、図2のよ うな識別子ST1、IE、OE、ST2、IO2およびO2によって識別される線形イオ ンガイド211、213、215、出口電極217、および衝突セル150に印加される ことができ、IEおよびOEは、それぞれ、線形イオンガイド213への入口および出口 を示す。IQ2におけるプロファイル300の中のピークは、出口電極217に印加され たDCポテンシャル障壁を表す。DCポテンシャルST1およびST2が、IEとOEと の間のDCポテンシャルよりも高いので、プロファイル300の中の線形イオンガイド2 11、213、215に印加されるDCポテンシャルは、線形イオンガイド213の中に イオン190を含有するポテンシャル井戸を作成し、その結果、イオン190を領域20 3の中に捕捉することができることがさらに認識される。いったんイオン190が捕捉さ れると、イオン190は、着目イオンの放射方向運動の周波数と共鳴した補助AC電場の 印加によって、選択的に放射方向に励起することができる。例えば、イオン190は、最 初に、線形イオンガイド211を介して線形イオントラップ200の中へ放出することが でき、次いで、イオン290は、プロファイル300の印加を介して、線形イオンガイド 2.1.3の中で捕捉し、冷却することができ、次いで、線形イオンガイド2.1.3に捕捉され たイオン190は、放射方向に励起されたイオン310を産生するように、線形イオンガ イド213の中で選択的に放射方向に励起することができる。例えば、放出過程は、1m sにわたって起こることができ、捕捉および冷却過程は、100msにわたって起こるこ とができ、励起過程は、1msにわたって起こることができる(共鳴状態にあるイオン1 90の放射方向運動を励起するように線形イオントラップ213のロッドに印加された6 0mVのAC電圧で)。さらに、線形イオントラップ213の中の圧力を上昇させること によって、捕捉および冷却過程のための時間を短縮することができる。いくつかの実装で は、捕捉期間中にバッファガス流を開くパルス状弁(図示せず)を利用することによって 、(例えば、IEとOEとの間の)捕捉領域の中の緩衝ガスの圧力を捕捉期間中に上昇さ せることができる。さらに、線形イオンガイド113に印加されるAC電場の少なくとも 周波数を制御することによって、放射方向に励起されたイオン310を産生するように、 イオン190の任意の好適な一部を励起のために選択できることが認識される。代替とし て、放射方向閉じ込めに使用されるRF電場の適切な振幅を選択することによって、着目 イオンの放射方向振動周波数を、所定のAC周波数と一致するように調整することができ る。さらに、選択の特異性は、概して、励起過程がより低い圧力で起こる時に、より高く したがって、パルス状弁は、イオンの急速捕捉のために、および励起過程中に緩衝ガス の圧力を低減するために有益となり得ることが認識される。

【0043】

しかしながら、いったん選択的放射方向励起が線形イオンガイド213の中で起こると、イオン190を線形イオンガイド215の中へ加速するように、第2のプロファイル303が質量分析計200において印加される。プロファイル303は、プロファイル300と実質的に同様であるが、ここでは線形イオンガイド215の中のDCポテンシャルは

10

20



、IEとOEとの間の(すなわち、線形イオンガイド213の中の)DCポテンシャルよ りも小さいことが認識される。したがって、放射方向に励起されたイオン310を含む、 プロファイル300による、線形イオンガイド213に捕捉されたイオン190は、ここ では、ポテンシャルの降下により出口領域207に向かって加速される。ポテンシャルの 降下は、長手方向力 F 1 を、放射方向に励起されたイオン 3 1 0 を含むイオン 3 1 0 に印 加させることが認識される。長手方向力F1はまた、以降でF1としても交換可能となる

(22)

[0044]

しかしながら、F1による、放射方向に励起されたイオン310を含むイオン190の 10 加速は、イオン190がIQ2/出口領域207におけるDCポテンシャル障壁を克服す るために十分ではないことが認識される。しかしながら、放射方向に励起されたイオン3 10は、出口領域207におけるRF電場強度の降下に起因するフリンジ擬似ポテンシャ ルにより、出口領域207において長手方向力F2(以降で交換可能に力F2と呼ばれる)を受ける。力F2はさらに、放射方向に励起されたイオン310の励起の振幅に依存し ており、励起されていないイオンは、F2を受けないことが認識される。したがって、力 F1による放射方向に励起されたイオン310が受ける加速、および力F2による放射方 向に励起されたイオン310が受けるさらなる加速の組み合わせが、放射方向に励起され たイオンに、IQ2におけるDCポテンシャル障壁を克服させ、線形イオントラップ20 0から流出させる。励起されていないイオンが力F2を受けないため、励起されていない 20 イオンは、F1に暴露されるにもかかわらず、線形イオントラップ200から流出しない

[0045]

図3では、Uaは、線形イオンガイド215の中の(すなわち、IEとOEとの間の) DCポテンシャルと、ST2におけるDCポテンシャルとの間の差であると認識される。 さらに、Ubは、ST2におけるDCポテンシャルとIQ2におけるDCポテンシャル障 壁との間の差であると認識される。Uaはまた、加速ポテンシャルUaと呼ぶこともでき 、Ubはまた、障壁の高さUbと呼ぶこともできる。

[0046]

したがって、0Vから約8.5Vに及ぶ障壁の高さUbについて、0V(曲線410) 、 - 0 . 2 V (曲線 4 2 0)、 - 1 V (曲線 4 3 0)、 - 2 V (曲線 4 4 0)、および -4 V (曲線450)の加速ポテンシャルUaに対する線形イオントラップ200の成功し たプロトタイプから流出する、放射方向に励起されたイオンのイオン強度の測定の結果を 図示する図4に注目する。図4はまた、 - 0 . 1 V (曲線460)、 - 1 V (曲線470)の加速ポテンシャルU a に対する線形イオントラップ200の成功したプロトタイプか ら流出する、励起されていないイオンのイオン強度の測定の結果も図示する。イオン強度 は、正規化されており、恣意的な単位を有する。Ubのゼロ点(すなわち、Ub=OV) は、高いおよび低い放射方向振幅を有するイオン間の分離を伴わずに、励起のないイオン が衝突セル150/Q2の中に効果的にトランスファするポテンシャルに対応する。励起 されたイオン(曲線410-450)と励起されていないイオン(曲線460、470) 40 との間の分離は、より高い障壁電圧において起こる。Ua=0Vを有する励起されたイオ ンに対応する曲線410は、任意の障壁電圧において、最も低い励起イオン強度(最低ト ランスファ効率に対応する)を有する。より高い軸方向エネルギーは、IQ2におけるD Cポテンシャル障壁を横断してトランスファするように放射方向に励起されたイオン 3 1 0を支援することが認識される。さらに、従来技術と比較して、放射方向に励起されたイ オン310の抽出の効率が向上させられるだけでなく、効率が高い、障壁の高さUbのポ テンシャルの範囲も増加させられ、したがって、線形イオントラップ200は、従来技術 と比較して、緩和電圧公差を有する。

[0047]

RAATの単純化された理論は、より高い軸方向エネルギーとともに(すなわち、放射 方向に励起されたイオン310への力F2に加えて印加される軸方向力F1とともに)、

イオン抽出の効率が増加する理由を説明することができる。理論は、イオン運動が2つの 力の影響を受けると仮定し、1つの力は、DCポテンシャル分布、すなわち、DC障壁力 に由来し、もう1つの力は、振動電圧、すなわち、力F2の正味の効果に由来する。力F 2は、擬似ポテンシャル力であると認識される。したがって、線形イオントラップ200 の中のイオン運動は、DCポテンシャルおよび擬似ポテンシャルの複合作用によって管理 されることが認識される。

【0048】

ポテンシャルおよび擬似ポテンシャル分布の重要な特徴は、「範囲」と呼ぶことができ る特性である。範囲は、ポテンシャル分布がわずかな値まで減少している、線形イオント ラップ200の長手軸に沿った距離であり、すなわち、範囲は、線形イオントラップ20 0の内側で、どれだけ深くそのポテンシャル分布が浸透するかという尺度である。 【0049】

一般に、IQ2におけるDC障壁ポテンシャル等のDCポテンシャルの範囲は、出口領 域207の中のRF電場縁による擬似ポテンシャル等の擬似ポテンシャルの範囲よりも大 きくなり得ることが認識される。該効果は、複合(ポテンシャルおよび擬似ポテンシャル)分布 U が、線形イオントラップ200の長さに沿った無次元座標(x)の関数として描 画される、図5Aで図示されている。×=0は、出口領域の中の線形イオントラップ20 0の内側の位置を画定し、具体的には、x=0は、IQ2におけるDCポテンシャル障壁 が、フリンジ電場を伴う領域(すなわち、出口領域207)付近で線形イオントラップ2 00の中のイオン190に影響を及ぼし始める、位置と一致するように選択される。 ×の より高い値は、フリンジ電場の効果が増加する、線形イオントラップ200の端部に向か った領域を表す。曲線501は、IQ2におけるDCポテンシャル障壁によるDCポテン シャル分布を示し、曲線501は、放射方向励起がないイオンがフリンジ電場領域(すな わち、出口領域207)から反射された時に受ける、ポテンシャルを表すことが認識され る。曲線503は、フリンジRF電場による擬似ポテンシャル分布を表す。曲線501を 曲線503と比較すると、擬似ポテンシャルは、DCポテンシャルの範囲の約半分しかな い範囲を有することが認識される。曲線505は、所与の強度に対する複合擬似ポテンシ ャル分布およびDCポテンシャル分布を図示する。図5の曲線501、503、および5 05は、RF擬似ポテンシャルUおよびDC障壁ポテンシャルの単純化×²モデルに基づ き、線形イオントラップ200では、×は、概して、線形イオントラップ200の軸に沿 った無次元座標を表し、×=0は、IQ2DC障壁の効果がごくわずかになる領域に対応 する、領域である一方で、x=1は、ちょうどIQ2障壁における場所に対応することが 認識される。×=0.5は、励起されたイオンに作用する擬似ポテンシャル場の大きさが 増大し始める、×座標に沿った中間点を画定することが認識される(例えば、曲線503 参照)。

【0050】

さらに、単純化 x² モデルは、例示目的のためにすぎず、実際のポテンシャルは、より 複雑な法則に従うことが認識される。

【0051】

いずれにしても、曲線505は、放射方向励起の所与の大きさに対して、出口領域20 40 7中の線形イオントラップ200の中の放射方向に励起されたイオン310が受ける、擬 似ポテンシャルおよびDCポテンシャルの合計を表す。これらの条件下で、このモデルに よれば、放射方向に励起されたイオン310は、そのようなポテンシャル分布を通してト ランスファさせられるために少なくとも0.3Vの軸方向エネルギーを必要とすることが 、曲線505から認識される。しかしながら、0.3Vは、近似値にすぎず、過度に限定 的と見なされるものではないことが認識される。いずれにしても、付加的な0.3Vの初 期イオンエネルギーを、第1の軸方向加速領域205からの力F1から取得することがで きる。そのエネルギーがない場合、たとえ放射方向に励起されたイオン310が十分な量 の放射方向励起を獲得していても、放射方向に励起されたイオン310は、IQ2におけ るDC障壁から流出することができない。上記で説明される例示的なx²モデルでは、少 50

(23)

20

10

20

30

40

なくとも0.3 Vの初期軸方向エネルギーを伴わない、放射方向に励起されたイオン310は、それらの放射方向励起(およびF2の大きさが)どれだけ高くても、障壁を横断することができない。しかしながら、線形イオントラップ200の成功したプロトタイプでは、放射方向に励起されたイオン310が線形イオントラップ200から流出するポテンシャルの範囲は、少し曖昧であり、十分高い励起において、放射方向に励起されたイオン 310は、IQ2における障壁を依然として横断することができるが、過程の効率は、図4の曲線410によって図示されるように損なわれる。

[0052]

曲線501、503、および505が適用可能である実装は、図2、ならびに以下で説 明される図6、9、11、および13によって表される。

【0053】

しかしながら、フリンジ擬似ポテンシャルに起因する力F2に加えて、DCポテンシャルの任意の好適な配設および実装、または放射方向に励起されたイオンを少なくとも1つの付加的な長手方向力に暴露するためのRF電場強度の変化が、本明細書の範囲内である

[0054]

ここで、複合(ポテンシャルおよび擬似ポテンシャル)分布 U が、図 5 A と同様に、線 形イオントラップ200の長さに沿った無次元座標(×)の関数として描画される、図 5 B に注目する。しかしながら、図 5 B は、擬似ポテンシャル(曲線 5 1 0)の範囲が D C 障壁ポテンシャル(曲線 5 1 2)の範囲よりも大きく、曲線 5 1 4 が曲線 5 1 0 および 5 1 2 の合計を表す、実装のポテンシャル分布を図示する。この配設では、励起されたイオ ンが線形イオントラップ 2 0 0 から選択的にトランスファさせられるために、いずれの初 期エネルギーも必要とされず、励起されていないイオンは、依然として D C 障壁によって 反発される。これらの実装では、付加的な力 F 1 は、トランスファ過程を加速し、それが 実際の用途では重要であるため、有益である。力 F 1 の別の利益は、ロッド上の種々の点 における表面帯電による、長手方向 D C ポテンシャルの不完全性の克服にある。そのよう な実装は、以下で説明される図 1 6、1 7、1 8、2 1、および 2 3 によって表される。 【0055】

ここで、「2」ではなく、「6」が先行する類似番号を有する類似要素を有する線形イ オントラップ200と同様の線形イオントラップ600を図示する図6に注目する。例え ば、入口領域601は、出口領域201と同様である。さらに、イオンビーム190、衝 突セル150、および検出器160も、図6のように図示されている。しかしながら、こ れらの実装では、線形イオンガイド613は、長手方向DCポテンシャルを提供するため の少なくとも1組の対向DC電極620を含む。DC電極620は、その間の距離が、線 形イオンガイド613への入口付近から線形イオンガイド613の出口付近まで増加する ようにテーパ状である。したがって、DC電極(および線形イオントラップ613の主要 ロッドセット)の間にDCポテンシャル差を印加することによって、減少するDCプロフ ァイルを、線形イオンガイド613の中に貯蔵されたイオン190に印加することができ 、長手方向DCポテンシャルをもたらし、したがって、軸方向力F1-Aが、線形イオン ガイドの中に貯蔵されたイオン190に印加される。

【0056】

代替として、DC電極620を除去し、線形イオンガイド613の主要ロッドセットを、抵抗被覆が塗布されているロッドセットと交換し、次に、任意のRFおよび/またはACポテンシャルに加えて、線形イオンガイド613の入口端に向かってDCポテンシャルを印加することによって、力F1-Aと同様の力をイオン190に印加することができる。したがって、イオン190は、線形イオンガイド613の入口端から線形イオンガイド613の出口端まで長手軸に沿って減少するDCポテンシャルを受け、したがって、長手方向加速力を受ける。

【0057】

さらに、図7に注目し、図7は、線形イオントラップ600を備える質量分析計におい 50

て印加することができるDCプロファイル700、701、703を図示する。DCプロ ファイル700および703は、それぞれ、図3のDCプロファイル300および303 と同様である。したがって、イオン190を、線形イオンガイド613の中のIEとOE との間に捕捉することができ、放射方向に励起されたイオン310と同様の放射方向に励 起されたイオン710を産生するように、選択的なAC励起電場を印加することができる 。次いで、DCポテンシャルがDC電極620に印加されるDCプロファイル701を印 加することができ、IEとOEとの間に減少するDC電場を産生し、したがって、放射方 向に励起されたイオン710を含む、線形イオンガイド613に捕捉されたイオン190 に、力 F1 - Aを印加する。次いで、放射方向に励起されたイオン710を含むイオンに カF1を印加するために、図3のDCプロファイル303と同様のDCプロファイル70 3を印加することができる。傾斜DC電場に起因する力F1-A、線形イオンガイド61 3と線形イオンガイド615との間のポテンシャル差に起因する力F1、および出口領域 606の中のフリンジ擬似ポテンシャルに起因する力 F2の組み合わせは、放射方向に励 起されたイオン710が、IQ2におけるDCポテンシャル障壁を克服し、線形イオント ラップ600から流出することを可能にする。励起されていないイオンが力F2を受けな いので、励起されていないイオンは線形イオントラップ600から流出しない。さらに、 放射方向に励起されたイオン710が、力F1-A、F1、およびF2の組み合わせによ り加速されるので、励起の振幅は、出口領域の中のDCポテンシャル障壁を克服するため に擬似ポテンシャル力のみに依存する、線形イオントラップの中のイオンを用いるよりも 小さくなり得る。

【0058】

線形イオンガイド613が多重極を備える実装では、線形イオンガイド613は、線形 イオンガイド613の中の各対のロッドに対する一対の対向DC電極620をさらに備え ることができる。例えば、図8は、線形イオンガイド613と同様の線形イオンガイド8 13の断面図を図示し、線形イオンガイド613は、四重極を備え、従って、2対のロッ ド815(合計で4本のロッド815)を有する。線形イオンガイド813はさらに、2 対の対向DC電極820を備え、各々は、各電極820が図7に図示されるように長手方 向にテーパ状であるようにDC電極620と同様である。したがって、1つまたは複数の 好適なAC電場を対向ロッド815に印加することによって、線形イオンガイド813に 捕捉されたイオンを、選択的に放射方向に励起することができ、放射方向に励起されたイ オンを含む、その中に捕捉されたイオンに力F1-Aを印加するために、DC電圧を対向 DC電極820に印加することによって、線形イオンガイド813の入口から出口まで減 少する傾斜DCポテンシャルを生成することができ、電極820に印加されるDC電圧とは異なる。

【0059】

ここで、図9に注目し、図9は、「6」ではなく、「9」が先行する類似番号を有する 類似要素を有する線形イオントラップ600と同様の線形イオントラップ900を図示す る。例えば、入口領域901は、出口領域601と同様である。さらに、イオンビーム1 90、衝突セル150、および検出器160も、図9のように図示されている。しかしな がら、これらの実装では、線形イオンガイド913は、例えば、図10に図示されるDC プロファイル1001の場合のように、異なるDCポテンシャルを印加することができる 少なくとも2つの対向する一連のDC電極920を含む。したがって、DC電極9200 間のDCポテンシャルは、線形イオンガイド9130中のIEとOEとの間においてDC ポテンシャルの減少を提供するために階段状となり得て、全体的な長手方向DCポテンシャ レをもたらし、したがって、軸方向力F1-Bが、線形イオンガイド913に貯蔵され たイオン190に印加される。線形イオンガイド913の断面図は、図8の線形イオンガ イド813の断面図と同様となり得る。図21に図示されるようないくつかの非限定的実 施例では、各DC電極920は、プリント回路基板(PCB)2100を備えることがで き、各PCB2100は、縁の上に電極2110(明確にするために1つだけの電極21 01が示されている)を有し、(例えば、電極2110はそれぞれのPCB21000縁 10

20

の上に配置される)、各PCB2110の縁は、線形イオントラップ913の各ロッドの 間に存在する。電極2110は、線形イオントラップ913の長手軸に向かっているPC B2100の縁まで延在することが認識される。PCB2100上の電極2110は、各 PCB2100の平坦面に沿った2つの側面、およびPCB2100の縁の上の1つの側 面といった、3つの側面を有することがさらに認識される。さらに、各一連の対向DC電 極920は、ここで説明されるように、一連の各連続電極920におけるDCポテンシャ ルステップとして、長手方向DCポテンシャルをイオン190に印加するように(例えば 、それぞれのPCB2100上で)独立して制御される。

[0060]

10 ここで、図23に注目し、図23は、「9」ではなく、「23」が先行する類似番号を 有する類似要素を有する線形イオントラップ900と同様の線形イオントラップ2300 を図示する。例えば、入口領域2301は、入口領域901と同様である。しかしながら 、図23では、線形イオンガイド2313の主要ロッドセットを分割し、力F1-Bと同 様の力F1-Eを印加するために異なるDC電圧を異なるセグメントに印加することによ って、DC電極920への同様の効果が達成される。これらの実装では、DC電極920 を除去することができる。代替として、線形イオンガイド2313の分割RF電極は、各 マ、それぞれのRF電圧で駆動され、それぞれのRF電圧は、放射方向加速領域2303 の入口端から放射方向加速領域2303の出口端まで減少する。例えば、各セグメントは 、以下で説明される図17の回路C1と同様の回路を介して接続することができ、および 20 /または各セグメントは独立して駆動することができる。

[0061]

ここで、図10に注目すると、図10は、線形イオントラップ900を備える質量分析 計において印加することができるDCプロファイル1000、1001、1003を図示 する。DCプロファイル1000および1003は、それぞれ、図7のDCプロファイル 700および703と同様である。したがって、イオン190を、線形イオンガイド91 3の中のIEとOEとの間に捕捉することができ、放射方向に励起されたイオン610と 同様の放射方向に励起されたイオン1010を産生するために、選択的なAC励起電場を 印加することができる。次いで、一連のDCポテンシャル差がDC電極920に印加され るDCプロファイル1001を印加することができ、IEとOEとの間に減少するDC電 場を産生し、したがって、イオンへの長手方向DCポテンシャルを産生し、放射方向に励 起されたイオン1010を含む、線形イオンガイド913に捕捉されたイオン190に力 F1 - Bを印加することをもたらす。次いで、放射方向に励起されたイオン1010を含 むイオンに力F1を印加するために、DCプロファイル1003を図3のように印加する ことができる。傾斜DC電場に起因する力F1-B、線形イオンガイド913と線形イオ ンガイド915との間のポテンシャル差に起因する力F1、および出口領域907の中の フリンジ擬似ポテンシャルに起因する力F2の組み合わせは、放射方向に励起されたイオ ン1010が、IQ2におけるDCポテンシャル障壁を克服し、線形イオントラップ90 0から流出することを可能にする。励起されていないイオンが力F2を受けないので、励 起されていないイオンは線形イオントラップ900から流出しない。さらに、放射方向に 励起されたイオン710が、力F1-B、F1、およびF2の組み合わせにより加速され るので、励起の振幅は、出口領域の中のDCポテンシャル障壁を克服するために、擬似ポ テンシャル力のみに頼る、線形イオントラップの中のイオンを用いるよりも小さくなり得 る。

[0062]

ここで、図11に注目すると、図11は、「6」ではなく、「11」が先行する類似番 号を有する類似要素を有する線形イオントラップ600と同様の線形イオントラップ11 00を図示する。例えば、入口領域1101は、出口領域601と同様である。さらに、 イオンビーム190、衝突セル150、および検出器160も、図9のように図示されて いる。しかしながら、これらの実装では、DCポテンシャルを印加することができる少な くとも1組の対向DC電極1120を含む線形イオンガイド1113の出口は、少なくと



も1つの出口電極1117に隣接する。言い換えれば、線形イオンガイド615の同等物 が、線形イオントラップ1100の中には存在しない。むしろ、DC電極1120に印加 されたDCポテンシャルは、軸上で長手方向DCポテンシャルをもたらし、したがって、 図12のDCプロファイル1201で図示されるように、軸方向力F1-Cが、線形イオ ンガイド1113に貯蔵されたイオン190に印加される。

(27)

【0063】

したがって、図12を参照すると、DCプロファイル1200、1201を、線形イオ ントラップ1100を備える質量分析計に印加することができる。DCプロファイル12 00および1201は、それぞれ、図7のDCプロファイル700および701と同様で あるが、ST2がDCプロファイル1200、1201にはない。むしろ、ST1におけ るDCポテンシャルDC障壁ポテンシャルIQ2によって、放射方向に励起されたイオン 1210が線形イオンガイド1113の中に含有される。次いで、DCポテンシャルを電 極1120に印加することによって、軸方向力F1-CがIEとOEとの間に印加され、 IQ2におけるDCポテンシャル障壁に向かって加速される放射方向に励起されたイオン 1210を含む、IEとOEとの間に捕捉されたイオンを、軸方向力F1-Cに加速させ る。傾斜DC電場に起因する力F1-C、および出口領域1107の中のフリンジ擬似ポ テンシャルに起因する力F2の組み合わせは、放射方向に励起されたイオン1210が、 IQ2におけるDCポテンシャル障壁を克服し、線形イオントラップ1100から流出す ることを可能にする。励起されていないイオンが力F2を受けないため、励起されていな いイオンは線形イオントラップ1100から流出しない。さらに、放射方向に励起された イオン1110が、カF1-CとF2との組み合わせにより加速されるので、励起の振幅 は、出口領域の中のDCポテンシャル障壁を克服するのに擬似ポテンシャル力のみに頼る 、線形イオントラップの中のイオンを用いるよりも小さくなり得る。したがって、図6お よび7に図示されるような軸方向力F1は、線形イオンガイド1100の中に存在しない が、カF1-Cの大きさは、軸方向力F1の欠如を補ってIQ2におけるDCポテンシャ ル障壁を克服するように調整される。

【0064】

いくつかの実装では、DCプロファイル1200が、最初に線形イオンガイド1113 の中にイオン190を捕捉するために、線形イオントラップ1100に印加される。次い で、DCプロファイル1201が、力F1-Cをイオン190に印加するように、線形イ オントラップ1100に印加される。しかしながら、力F1-Cは、放射方向に励起され たイオン1210が、IQ2におけるDC障壁(例えば、図5Aの場合のような0.3V)を克服することに十分なエネルギーおよび / または加速を得るために、所与の期間中に のみ印加される。実際に、イオン190および/または放射方向に励起されたイオン12 10が、線形イオンガイド1113に沿って空間的に分布するので、線形イオンガイド1 113の出口領域により近い励起されていないイオン190は、いったん力F1-Cが印 加されるとIQ2におけるDCポテンシャル障壁から反射され、線形イオンガイド111 3の出口領域に隣接する領域の中に捕捉され、印加されているDCおよび / またはRF電 場に影響を及ぼし得る空間電荷の蓄積につながる可能性があることが認識される。さらに 、IE(すなわち、線形イオンガイド1113の入口)により近い、励起されていないイ オン190を含むイオン190は、より長期間にわたって力F1-Cを受け、IQ2にお けるDCポテンシャルに遭遇する前に、より多くのエネルギーを得る。これは、着目イオ ンに対する軸方向エネルギーの広い広がりをもたらし、次に、励起されたイオンと励起さ れていないイオンとの間の分離の質を損なう。図4に示される曲線460および440の U。軸に沿ったぼやけを画像化することによって、軸方向エネルギーの広がりの悪影響を 可視化できることに留意されたい。励起されていないイオンに対するぼやけた曲線(46 0)が、励起されたイオンに対するぼやけた曲線(曲線440)と重複し始めるときに、 励起されたイオンと励起されていないイオンとの間の分離が損なわれる。

[0065]

したがって、いくつかの実装においてこの問題を克服するために、DCプロファイル1 ⁵⁰

30

20

201は、イオン190がIEからOEへ進行するための時間よりも10~100倍短い 期間にわたって印加される。したがって、F1-Cの大きさは、それに従って選択するこ とができ、放射方向に励起されたイオン1210が、IQ2におけるDCポテンシャル障 壁を克服するのに十分な量のエネルギーを軸方向に得るように十分長いが、イオン190 のごくわずかのみが、F1-Cの印加中にIQ2における反射を受けるように十分短く、 カF1-Cを印加することができる。F1-Cの印加中にIO2において反射されるイオ ンは、残りのイオン(すなわち、IQ2から反射されないイオン)と同じ量の軸方向エネ ルギーを得ないことが認識される。したがって、場合によっては、IQ2において反射さ れるイオンのごくわずかは、たとえ放射方向励起があったとしても、RAAT技法を使用 してトランスファさせられない場合がある。そのイオンのごくわずかは、分析のために失 われる。しかしながら、ごくわずか(例えば、イオンの10%)の損失は、用途の大部分 にとって容認可能である。したがって、放射方向に励起されたイオン1210を捕捉し、 励起させ、トランスファさせるためのサイクルは、DCプロファイル1200を使用して イオン190を捕捉し、放射方向に励起されたイオン1210を産生するように選択され た一群のイオン190を励起させ、力F1-Cを使用してイオンを「蹴飛ばす」ように短 期間にわたってDCプロファイル1201を印加し、DCプロファイル1200を再印加 し、放射方向に励起されたイオン1210をトランスファさせることを含むことができる 。線形イオントラップ600、900、1300、2300、2400ならびに同様の問 題が発生する任意の他の実装の中で、同じ種類のイオンに対する軸方向エネルギーの広が りを生じることを回避するために、同様の原則をDCプロファイル701、1001の印 加に適用できることが認識される。

【0066】

ここで、「11」ではなく、「13」が先行する類似番号を有する類似要素を伴う、線 形イオントラップ1100と同様の線形イオントラップ1300を図示する、図13に注 目する。例えば、入口領域1301は、出口領域1101と同様である。しかしながら、 線形イオントラップ1300では、DC電極1220は、図9のDC電極920と同様の DC電極1320に置換されている。したがって、長手方向DCポテンシャルをもたらす 、図14のDCプロファイル1401の場合のように、階段状の減少するポテンシャルを 、DC電極1320の間に印加することができる。DCプロファイル1400および14 01は、図12のDCプロファイル1200および1201と同様であり、線形イオント ラップ1100を備える質量分析計と同様に印加することができるが、DCプロファイル 1401は、放射方向に励起されたイオン1410を含む、その間に捕捉されたイオンに 印加される、階段状の減少するDCポテンシャルをIEとOEとの間に備え、長手方向D Cポテンシャル、したがって、上記で説明されるように、軸方向力 F2と組み合わせて、 IQ2におけるDC障壁ポテンシャルを克服することを支援する、放射方向に励起された イオン1410への軸方向力F1-Dをもたらす。加えて、DCプロファイル1401を 印加するための時間の長さを決定するために、DCプロファイル1201と関連付けられ るものに対する原則を使用することができる。

[0067]

代替として、図23と同様に、線形イオンガイド1313の主要ロッドセットを分割し 4 、異なるDC電圧を異なるセグメントに印加することによって、DC電極1320への同 様の効果を達成することができる。これらの実装では、DC電極1320を除去すること ができる。

【0068】

ここで、「2」ではなく、「15」が先行する類似番号を有する類似要素を伴う、線形 イオントラップ200と同様の線形イオントラップ1500を図示する、図15に注目す る。例えば、入口領域1501は、入口領域201と同様である。しかしながら、線形イ オントラップ1500では、線形イオンガイド213、215は、第1の軸方向加速領域 1505とも呼ばれる領域1505を含む、単一の線形イオンガイド1513に置換され ている。これらの実装では、第1の軸方向加速領域1505の中の放射方向に励起された 10



イオン190の加速は、放射方向に励起されたイオン190への擬似ポテンシャル長手軸 方向力をその間で生成するように、第1の軸方向加速領域1505の中でRF電場におけ る差を提供することによって起こる。例えば、RF電極(例えば、多重極を構成するロッ ド)の間の距離が、RF電極の形状の変化により、第1の軸方向加速領域1505の中で 増加するように、RF電極が直径の変化を有するため、RF勾配が第1の軸方向加速領域 1505の中で提供される。図15の図示した実装では、RF電極はテーパ状である。し たがって、線形イオンガイド1513の中の多重極のロッドの間に印加されたRF電場に おける差が、領域1505をもたらし、軸方向擬似ポテンシャル長手方向力F2-Aを、 領域1505の中の放射方向に励起されたイオンに印加させる。したがって、軸方向力F 2-Aおよび軸方向力F2の組み合わせは、放射方向に励起されたイオンが、IQ2にお いて印加されたDCポテンシャル障壁を克服し、線形イオントラップ1500から流出す ることを可能にする。さらに、励起されていないイオンが力F2-Aまたは力F2を受け ないため、励起されていないイオンは線形イオントラップ1500から流出しない。 【0069】

ここで、類似番号を有するが、「15」ではなく、「16」が先行する類似要素を伴う 、線形イオントラップ1500と同様の線形イオントラップ1600を図示する、図16 に注目する。例えば、入口領域1601は、入口領域1501と同様である。しかしなが ら、線形イオントラップ1600では、線形イオンガイド1613は線形イオンガイド1 513と同様であるが、線形イオンガイド1613の中のRF電極(例えば、ロッド)は 、急激または段階的な変化を領域1605の中で有し、上記で説明される軸方向力F2-Aと同様に、軸方向擬似ポテンシャル長手方向力F2-Bを、領域1605の中の放射方 向に励起されたイオンに印加させる。したがって、軸方向力F2-Bおよび軸方向力F2 の組み合わせは、放射方向に励起されたイオンが、IQ2において印加されたDCポテン シャル障壁を克服し、線形イオントラップ1600から流出することを可能にする。さら に、励起されていないイオンが力F2-Bまたは力F2を受けないため、励起されていな いイオンは線形イオントラップ1600から流出しない。

【0070】

ここで、図20に注目すると、図20は、類似番号を有するが、「15」ではなく、「 20」が先行する類似要素を伴う、線形イオントラップ1500と同様の線形イオントラ ップ2000を図示する。例えば、入口領域2001は、入口領域1501と同様である 。しかしながら、線形イオントラップ2000では、線形イオンガイド2013は線形イ オンガイド1513と同様であるが、線形イオンガイド2013の中のRF電極(例えば 、ロッド)の間の距離は、領域2005の中の直径の減少を介して増加し、上記で説明さ れる軸方向力F2-Aと同様に、軸方向擬似ポテンシャル長手方向力F2-Dを、領域2 005の中の放射方向に励起されたイオンに印加させる。したがって、軸方向力F2-D および軸方向力F2の組み合わせは、放射方向に励起されたイオンが、IQ2において印 加されたDCポテンシャル障壁を克服し、線形イオントラップ20000から流出すること を可能にする。さらに、励起されていないイオンが力F2-Dまたは力F2を受けないた め、励起されていないイオンは線形イオントラップ2000から流出しない。 【0071】

ここで、図17に注目すると、図17は、類似番号を有するが、「2」ではなく、「1 7」が先行する類似要素を有する線形イオントラップ200と同様の線形イオントラップ 1700を図示する。例えば、入口領域1701は、入口領域201と同様である。しか しながら、線形イオントラップ1700では、線形イオンガイド1713に印加されるR F電場が、同様のRF電場を線形イオンガイド1715に印加させるが、振幅および/ま たは位相の差を伴うように、線形イオンガイド1713は、コンデンサC1を介して線形 イオンガイド1715に電気的に接続される。領域1705の中のRF電場のそのような 変化は、上記で説明される軸方向力F2-Aと同様に、軸方向擬似ポテンシャル長手方向 力F2-Cを、領域1705の中の放射方向に励起されたイオンに印加させる。したがっ て、軸方向力F2-Cおよび軸方向力F2の組み合わせは、放射方向に励起されたイオン 10

20

30

10

20

が、IQ2において印加されたDCポテンシャル障壁を克服し、線形イオントラップ17 00から流出することを可能にする。さらに、励起されていないイオンが力F2-Cまた は力F2を受けないので、励起されていないイオンは線形イオントラップ1700から流 出しない。

[0072]

ここで、図22に注目すると、図22は、類似番号を有するが、「17」ではなく、「 22」が先行する類似要素を伴う、線形イオントラップ1700と同様の線形イオントラ ップ2200を図示する。例えば、入口領域2201は、入口領域1701と同様である 。しかしながら、線形イオントラップ2200では、IQ2におけるDC障壁は、線形イ オンガイド2215のほぼ中央からほぼ端部まで線形イオンガイド2215のロッドの間 に延在する補助電極2217によって産生される。これらの実装では、励起されたイオン が補助電極2217によって生成されるDC障壁を登った後に、F2が励起されたイオン に印加されるため、励起されたイオンに作用するF2は、IQ2におけるDC障壁が電極 1717によって産生される時よりもはるかに小さくなり得る。したがって、これらの実 装では、主に力F2-Cと同様の力F2-Eを受けることによって、線形イオントラップ 220から流出することに関して、励起されたイオンは、励起されていないイオンと区別 される。励起されたイオンおよび励起されていないイオンの両方は、線形イオントラップ 2215のほぼ中央に到達し、励起されていないイオンは、補助電極2217によって印 加されるDCポテンシャルの作用によって跳ね返される。励起されたイオンは、補助電極 2217によるDC障壁を乗り越えるのに十分なエネルギーをF2-Eから獲得する。こ れらの実装での出口領域2209は、補助電極2217の出口端の近位にあることが認識 される。

[0073]

その上さらに、線形イオンガイド1500、1600、1700では、カF2と組み合わせて、それぞれカF2-A、F2Bが、放射方向に励起されたイオンを線形イオンガイド1500、1600、1700から流出させるように、それぞれ、DC電極1517、 1617、1717を、補助電極2217と同様の補助電極と置換できることが認識される。

【0074】

30 ここで、図24に注目すると、図24は、類似番号を有するが、「22」ではなく、「 2.4」が先行する類似要素を伴う、線形イオントラップ2.2.0.0と同様の線形イオントラ ップ2400を図示する。例えば、入口領域2401は、入口領域2201と同様である 。しかしながら、カF2がもはや存在しないように(F2は、RF電場の変化に起因する)、線形イオンガイド2415に印加されるRF電場の強度RF1は、衝突セル150に 印加されるRF電場と同じ強度RF1である。これを克服するために、カF1-Bと同様 の力F1-Eをイオン190に印加することができるように、線形イオンガイド2413 は、DC電極920(および/またはDC電極1320)と同様のDC電極2420を備 える。代替として、イオン190および/または放射方向に励起されるイオン190に長 手軸方向力を印加することができるように、DC電極2420を、図6のDC電極620 40 と同様のDC電極と置換することができる。図23の分割線形イオンガイド2313およ び/または線形イオントラップ2413のロッド上の抵抗被覆を含むが、それらに限定さ れない、領域2403の中で長手軸方向力を印加するための任意の他の好適な方法および /または装置は、本実装の範囲内であることがさらに認識される。

【0075】

いずれにしても、これらの実装では、放射方向加速領域2403は、第1の加速領域2 405を備え、第2の加速領域2407は、線形イオンガイド2413、2415の間の 遷移領域であり、第2の加速領域2407は、出口領域2409からさらに遠く離れている。

[0076]

ここで質量分析計1800を図示する図18を注目すると、質量分析計1800は、イ 50

オン源1820と、イオンガイド1830と、線形イオントラップ1840と、衝突セル 1850(例えば、断片化モジュール)と、検出器1860とを備え、質量分析計180 0は、イオン源1820から検出器1860までイオンビームを伝送することが可能であ る。一般に、質量分析計1800は、質量分析計100と同様である。線形イオントラッ プ1840は、RAATのために使用可能な任意の線形イオントラップを備え、したがっ て、出口電極217と同様の出口電極1870は、線形イオントラップ1840端部領域 1872に位置することが認識される。したがって、イオン源1820からのイオン18 90の一部分が、線形イオントラップ1840の中で放射方向に励起されるにつれて、力 F2が、上記で説明される軸方向加速領域207と同様の第2の軸方向加速領域1877 の中で、放射方向に励起されたイオン1890に印加される。

(31)

【0077】

しかしながら、カF2が、放射方向に励起されたイオンが出口電極1870のDCポテ ンシャルを克服することを可能にするのに十分ではないように、線形イオントラップ18 40の中のイオンの放射方向励起は、閾値以下に保たれる。むしろ、線形イオントラップ 1840の中へ放出される前に、イオン1890は、イオン1890の少なくとも一部分 に印加される長手方向DCポテンシャルによる長手軸方向力F18を第1の加速領域18 75の中で受ける。図示した実装では、第1の加速領域1875は、イオンガイド183 0の中、および / またはイオン源1820と線形イオントラップ1840との間の任意の 他の好適な場所に位置する。力F18はまた、線形イオントラップ1840の中で放射方 向に励起されないイオン1890が、出口電極1870におけるポテンシャル障壁を克服 できないように、好適な閾値以下に保たれる。むしろ、力F18および力F2の両方を受 ける、放射方向に励起されたイオン1890のみが、出口電極1870によるポテンシャ

【0078】

第1の加速領域1875は、イオン源1820と線形イオントラップ1840との間の 任意の好適な位置に位置することができる。さらに、軸方向力F18は、任意の好適な装 置、例えば、図6のDC電極620、図8のDC電極820、図9のDC電極920、図 11のDC電極1120、図13のDC電極1320、または同等物の任意の好適な組み 合わせを使用して、産生することができる。

【0079】

ここで、図19に注目すると、図19は、質量分析計における放射方向振幅支援トランスファ(RAAT)のための方法1900を図示する。方法1900の説明を支援するために、方法1900は、質量分析計100、1800および/または線形イオントラップ200、600、800、900、1100、1300、1500、1600、1700、または1800のうちのいずれか1つを使用して行われるが、説明は、説明の所与の部分に適するような質量分析計100、1800および/または線形イオントラップ200、600、800、900、1100、1500、1600、1700、または1800を参照することが仮定される。さらに、方法400の以下の論議は、質量分析計100、1800および/または線形イオントラップ200、600、800、900、1100、1500、1600、1700、または1800、ならびにそれらの種々の構成要素のさらなる認識につながる。しかしながら、質量分析計100、1800および/または線形イオントラップ200、600、800、900、1100、1300、1500、1600、800、900、1100、1300、1500、1700、または1800、および/または点線形イオントラップ200、600、800、900、1100、1300、1500、1700、または1800、および/または方法1900は、変化させることができ、相互と併せて本明細書で論議されるように正確に機能する必要はなく、そのような変化例は、本開示の範囲内であると認識されたい。

[0080]

ステップ1903では、イオン190が、上記で説明されるように、イオン源120からRAATに使用可能な線形イオントラップ200の中へ放出される。いくつかの代替実 装では、イオン源120からのイオン190は、(例えば、質量分析計1800および線 形イオントラップ1820を参照して上記で説明されるように)ステップ1903で線形

30

20

10

40

(32)

イオントラップ200の中へ放出される前に、質量分析計100の長手軸に沿って加速さ れる。

[0081]

ステップ1905では、イオン190の少なくとも一部分が、放射方向に励起されたイ オンを産生するように線形イオントラップ200の中において放射方向に励起される。 [0082]

ステップ1907では、イオン190および放射方向に励起されたイオンのうちの少な くとも1つが、質量分析計の長手軸に沿って加速される。いくつかの実装では、ステップ 1901およびステップ1907のうちの1つが起こるが、他の実装では、ステップ19 01および1907の両方が起こる。

[0083]

ステップ1909では、放射方向に励起されないイオン190が、線形イオントラップ 200の中にとどまっている間に、加速するステップ1907(および/または加速する ステップ1901)およびさらに加速するステップ1909による、放射方向に励起され たイオンへの力の組み合わせが、放射方向に励起されたイオンに出口領域209における DCポテンシャル障壁を克服させるように、放射方向に励起されたイオンが、 RF電場強 度の低減によって産生される擬似ポテンシャルにより、長手軸に沿ってさらに加速され、 それにより、ステップ1911において放射方向に励起されたイオンを抽出する。

[0084]

20 ステップ1901が起こるときに、加速するステップは、放射方向に励起するステップ 1905の前に起こり、加速するステップ1901は、イオン源120と線形イオントラ ップ200との間で起こる。

[0085]

加速するステップ1907は、線形イオントラップ1500、1600、および170 0の場合のように、放射方向に励起されたイオンへの擬似ポテンシャル長手軸方向力をそ の間に生成するように、出口領域207より前の線形イオントラップ200の中でRF電 場における差を提供することによって起こり得る。加速するステップ1907(および/ または加速するステップ1901)は、代替として、イオン190および放射方向に励起 されたイオンのうちの少なくとも1つへの長手方向DCポテンシャルを提供することによ って起こり得る。

[0086]

加速するステップ1907がRF電場における差を提供することによって起こる場合に

線 形 イ オ ン ト ラ ッ プ 1 5 0 0 、 1 6 0 0 の 中 の R F 電 極 の 間 の 増 加 す る 放 射 距 離 と 、 線形イオントラップ1500、1600の場合のように、RF電極の形状の変化と、 線形イオントラップ1500の少なくとも一部分の場合のように、RF電極がテーパ状 であることと、

線形イオントラップ1600の少なくとも一部分の場合のように、RF電極が階段状で あることと、

第 1 組の R F 電極 1 7 1 3 および出口領域 1 7 0 9 に隣接する第 2 組の電極 1 7 1 5 が RF電場における差を生じさせる回路を介している、線形イオントラップ1700を提 供することと、のうちの少なくとも1つによって、RF勾配を提供することができる。 [0087]

加速するステップ1907(および/または加速するステップ1901)が長手方向D Cポテンシャルを提供することによって起こる場合に、線形イオントラップ600および 1100の場合のように、長手方向に延在する少なくとも1組のDC電極620または1 120の間の距離を増加させることによって、長手方向DCポテンシャルを提供すること ができる。代替として、長手方向DCポテンシャルは、線形イオントラップ900および 1300の場合のように、長手方向に延在する一連の対向DC電極920または1320 、長手方向DCポテンシャルを産生するための一連の対向DC電極620、1120を使 30

10

用して提供することができ、一連の対向DC電極620、1120は、一連の各連続電極 におけるDCポテンシャルステップとして、長手方向DCポテンシャルをイオン190に 印加するように独立して制御される。代替実装では、図23に図示されるように、主要ロ ッドセットを分割し、異なるDC電圧を異なるセグメントに印加することによって、長手 方向DCポテンシャルを線形イオントラップ200の中のイオンに印加することができる 。その上さらなる代替実装では、抵抗被覆とともに電極を利用することによって、長手方 向DCポテンシャルを線形イオントラップ200の中のイオンに印加することができる。 長手方向力はまた、進行波を備えることもできる。実際に、長手方向力を印加するための 任意の好適な方法および/または装置は、本実装の範囲内であることが認識される。 【0088】

いくつかの実装では、ステップ1911において線形イオントラップから放射方向に励起されたイオンを抽出することが、選択的な放射方向励起中に線形イオントラップ200の放射方向加速領域203の中にイオン190を捕捉するために、出口領域209に隣接して第1のDCポテンシャルを印加するステップをさらに含むことができ、第1のDCポテンシャルは、図3のように、放射方向励起領域203の中のDCポテンシャルよりも大きい。次いで、再び図3のように、放射方向励起領域203の中のイオン190が、出口領域209へ加速され、長手方向DCポテンシャルおよび擬似ポテンシャルによる、放射方向に励起されたイオンへの力の組み合わせが、放射方向に励起されたイオンに電極217によるDCポテンシャル障壁を克服させるために、出口領域209に隣接する第2のDCポテンシャルが印加され、第2のDCポテンシャルよりも小さく、放射方向励起203の中のDCポテンシャルよりも小さい。いくつかの実装では、第2のDCポテンシャルを印加する前に、図7のように、減少するDCポテンシャルが放射方向励起領域203の中に印加され、したがって、付加的な加速力を放射方向に励起されたイオンに印加する。

【0089】

したがって、RAAT使用可能線形イオントラップの中に発生する長手軸方向力(また は複数の力)および擬似ポテンシャルの組み合わせを使用することによって、RAAT使 用可能線形イオントラップの中のイオンを選択的に抽出するための放射方向励起の程度を 低減することができ、それにより、RAAT使用可能線形イオントラップの抽出の角度を 減少させ、抽出効率を増加させる。

【0090】

当業者であれば、実装例を実装するために可能なさらに多くの実装例および修正があり、 上記の実装例および実施例は、1つ以上の実装例の例示にすぎないことを認識するであ ろう。したがって、範囲は、本明細書に添付される請求項のみによって限定されるもので ある。 10

【図1】









【図4】



【図5A】



【図 5 B】







【図7】











【図11】



FIG. 11









【図14】



【図15】



FIG. 15





【図18】







FIG. 19





【図22】



FIG. 22

【図23】



FIG. 23



FIG. 24

フロントページの続き

審査官 桐畑 幸 廣

(56)参考文献 特表平11-510946(JP,A) 特開2011-175982(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01J 49/42 H01J 49/06